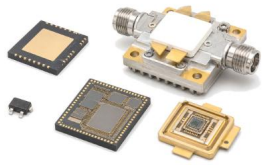
Catálogo de productos

Circuitos RF, MMIC y dispositivos semiconductores

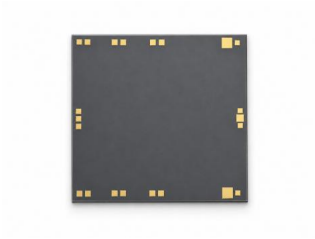
Bloques RF activos para amplificación, conversión, conmutación, detección, control y síntesis, organizados por función sin atribuir prestaciones no verificadas a modelos concretos.



Productos: 315

Revisión: 24 · Fecha de revisión: 2026-11-12

Amplificadores RF MMIC



LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 11500–18000 MHz

Amplificador de potencia MMIC GaN en chip desnudo para etapas de transmisión de 11,5 a 18 GHz. Admite onda continua y pulsos e integra bloqueo de continua en ambos trayectos RF.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 11500; Máximo: 18000; Valor: 11500–18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

14000–18000 MHz Die de amplificador de potencia GaN MMIC de

Potencia de salida saturada: 42 dBm (mínimo) / 42.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (mínimo) / 22.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 35 % (mínimo). Dimensiones del die: 3 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Mínimo: 42; Típico: 42.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-14200-16800-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 14200–16800 MHz

pulsado: PSAT: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensiones del die: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14200; Máximo: 16800; Valor: 14200–16800; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-14500-17200-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 14500–17200 MHz

pulsado: PSAT: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensiones del die: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14500; Máximo: 17200; Valor: 14500–17200; Unidad: MHz

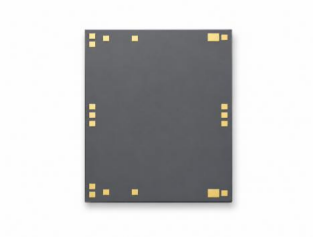
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 13750–14500 MHz

pulsado: PSAT: 45 dBm (mínimo); Ganancia de potencia: 20 dB (mínimo); PAE: 37 % (mínimo) / 38 % (típico). Dimensiones del die: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 13750; Máximo: 14500; Valor: 13750–14500; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13750-15250-PS46T

13750–15250 MHz Die de amplificador de potencia GaN MMIC de

Potencia de salida saturada: 46 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 33 % (típico). Dimensiones del die: 5 × 6 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 13750; Máximo: 15250; Valor: 13750–15250; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Típico: 46; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Máximo: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

8000–12000 MHz Die de amplificador de potencia GaN MMIC de

Potencia de salida saturada: 48 dBm (mínimo) / 48.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 23 dB (mínimo) / 23.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 44 % (típico). Dimensiones del die: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 23; Típico: 23.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 13800–18200 MHz

PSAT: 47 dBm (mínimo) / 47.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (mínimo) / 21.5 dB (típico); PAE: 33 % (típico). Dimensiones del die: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 13800; Máximo: 18200; Valor: 13800–18200; Unidad: MHz

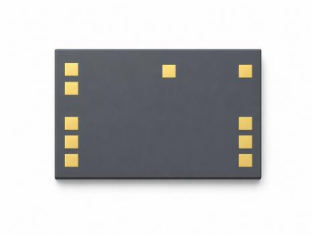
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 21.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 14000–18000 MHz

PSAT: 37 dBm (mínimo) / 37.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 15 dB (mínimo) / 15.5 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensiones del die: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 37; Típico: 37.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 15; Típico: 15.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 12200–16000 MHz

PSAT: 46 dBm (mínimo) / 46.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 19 dB (mínimo) / 19.5 dB (típico); PAE: 33 % (típico). Dimensiones del die: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 12200; Máximo: 16000; Valor: 12200–16000; Unidad: MHz

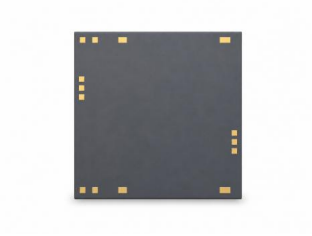
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 26000–40000 MHz

Ganancia de potencia: 15 dB (típico); PSAT: 40.5 dBm (típico); PAE: 23 % (típico). Dimensiones del die: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 26000; Máximo: 40000; Valor: 26000–40000; Unidad: MHz

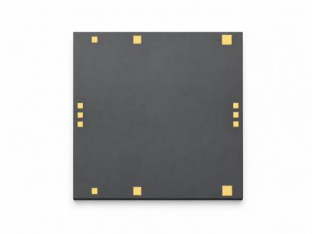
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 22; Unidad: dB

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 15; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-31000-37000-PS41T

Die de amplificador de potencia MMIC de 31000–37000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); PAE: 26 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 21 dB (típico). Dimensiones del die: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 31000; Máximo: 37000; Valor: 31000–37000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-33000-37000-PS45T

Die de amplificador de potencia MMIC de 33000–37000 MHz

PSAT: 45 dBm (típico); PAE: 22 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 23 dB (típico). Dimensiones del die: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 33000; Máximo: 37000; Valor: 33000–37000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 18000–40000 MHz

PSAT: 40.5 dBm (típico); PAE: 15 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 21 dB (típico). Dimensiones del die: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 18000; Máximo: 40000; Valor: 18000–40000; Unidad: MHz

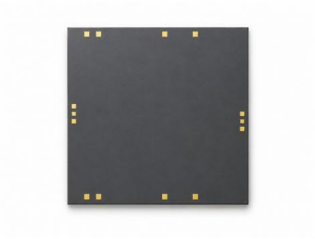
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 40.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-92000-96000-PS36T

Die de amplificador de potencia MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 36 dBm (típico); PAE: 9 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 19 dB (típico). Dimensiones del die: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 36; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-27000-31000-PS43T

Die de amplificador de potencia de 27000–31000 MHz

PSAT: 43 dBm (típico); PAE: 28 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 23 dB (típico). Dimensiones del die: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 27000; Máximo: 31000; Valor: 27000–31000; Unidad: MHz

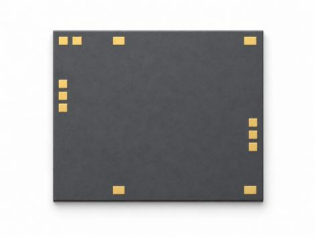
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.5; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-50000-63000-PS37T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 50000–63000 MHz

PSAT: 37 dBm (típico); PAE: 20 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 18 dB (típico). Dimensiones del die: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 50000; Máximo: 63000; Valor: 50000–63000; Unidad: MHz

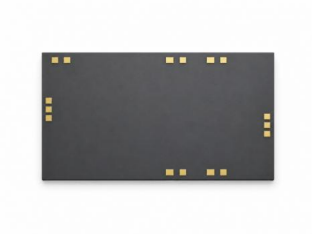
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 18; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1.5; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 37; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-92000-96000-PS34T

Die de amplificador de potencia MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 34 dBm (típico); PAE: 10 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 19 dB (típico). Dimensiones del die: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidad: MHz

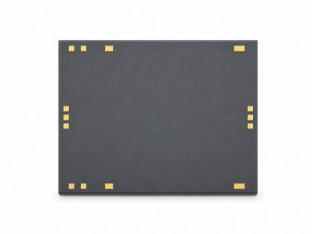
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 34; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-18000-26500-PS41T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 18000–26500 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); PAE: 26 % (típico); Ganancia de potencia: 19 dB (típico). Dimensiones del die: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 18000; Máximo: 26500; Valor: 18000–26500; Unidad: MHz

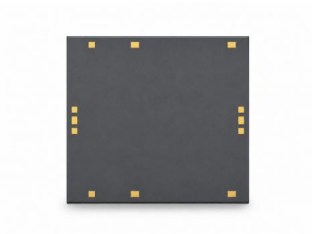
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.4; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-27000-31000-PS42T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 27000–31000 MHz

PSAT: 42 dBm (típico); PAE: 30 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 23 dB (típico). Dimensiones del die: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 27000; Máximo: 31000; Valor: 27000–31000; Unidad: MHz

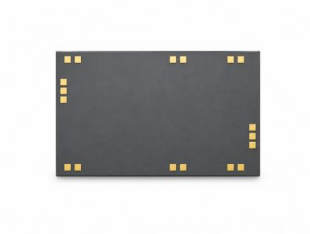
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-15000-43000-PS30T

Die de amplificador de potencia de 15000–43000 MHz

PSAT: 30 dBm (típico); PAE: 18 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 18 dB (mínimo) / 20 dB (típico) / 22 dB (máximo). Dimensiones del die: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 43000; Valor: 15000–43000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Mínimo: 18; Típico: 20; Máximo: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±2; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 29.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

Die de amplificador de potencia de 92000–96000 MHz

PSAT: 26.5 dBm (típico); PAE: 12 % (típico) / 13 % (máximo); Ganancia de pequeña señal: 18 dB (típico). Dimensiones del die: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 18; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.5; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 26.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 15000–17000 MHz

PSAT: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); PAE: 37 % (típico). Dimensiones del die: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 17000; Valor: 15000–17000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-12700-14500-PS47T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 12700–14500 MHz

pulsado: PSAT: 46.8 dBm (mínimo) / 47 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18.8 dB (mínimo) / 19 dB (típico); PAE: 37 % (típico). Dimensiones del die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 12700; Máximo: 14500; Valor: 12700–14500; Unidad: MHz

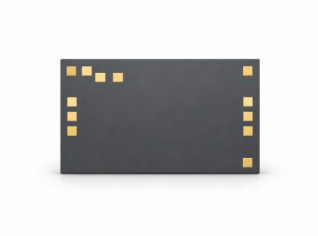
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.8; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 18.8; Típico: 19; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-15000-18000-PS38T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 15000–18000 MHz

pulsado: PSAT: 38 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); PAE: 40 % (típico). Dimensiones del die: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 18000; Valor: 15000–18000; Unidad: MHz

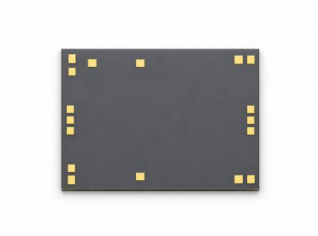
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 38; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13000-15000-PS42T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 13000–15000 MHz

pulsado: PSAT: 42 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); PAE: 35 % (mínimo) / 37 % (típico). Dimensiones del die: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 13000; Máximo: 15000; Valor: 13000–15000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.35; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 12000–15000 MHz

pulsado: PSAT: 47 dBm (mínimo) / 47.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (mínimo) / 22.5 dB (típico); PAE: 30 % (mínimo) / 34 % (típico). Dimensiones del die: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 12000; Máximo: 15000; Valor: 12000–15000; Unidad: MHz

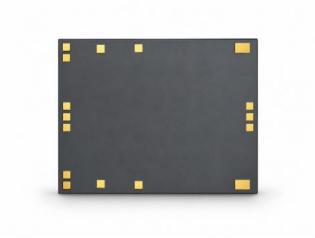
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 15000–17000 MHz

pulsado: PSAT: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); PAE: 43 % (típico). Dimensiones del die: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 17000; Valor: 15000–17000; Unidad: MHz

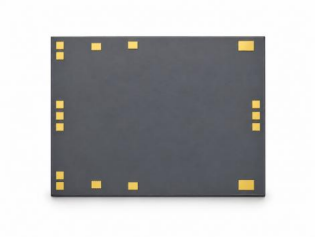
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-14000-18000-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 14000–18000 MHz

pulsado: PSAT: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); PAE: 41 % (típico). Dimensiones del die: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-15000-18500-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 15000–18500 MHz

pulsado: PSAT: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensiones del die: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 18500; Valor: 15000–18500; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13750-15350-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 13750–15350 MHz

pulsado: PSAT: 47 dBm (mínimo) / 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 19 dB (mínimo) / 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensiones del die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 13750; Máximo: 15350; Valor: 13750–15350; Unidad: MHz

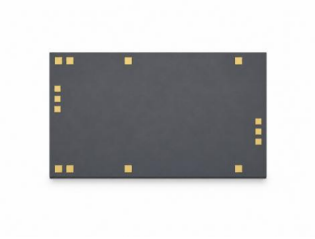
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-34000-64000-PS30T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 34000–64000 MHz

PSAT: 30 dBm (típico); PAE: 17 % (típico); Ganancia de potencia: 17 dB (típico). Dimensiones del die: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 34000; Máximo: 64000; Valor: 34000–64000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 27; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 30; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

Die de amplificador de potencia MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 34.5 dBm (típico); PAE: 14 % (típico); Ganancia de pequeña señal: 22 dB (típico). Dimensiones del die: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: S21; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 34.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

8000–12000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 0.7 dB (típico) / 0.75 dB (máximo); Ganancia de pequeña señal: 26.5 dB (mínimo) / 28 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensiones del die: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 10; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Mínimo: 26.5; Típico: 28; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±1.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

8000–12000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 0.7 dB (típico) / 0.75 dB (máximo); Ganancia de pequeña señal: 26.5 dB (mínimo) / 28 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensiones del die: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 10; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Mínimo: 26.5; Típico: 28; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±1.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

14000–15000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 1.1 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 32 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 5 dBm (típico). Dimensiones del die: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 14000; Máximo: 15000; Valor: 14000–15000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Típico: 32; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

14000–15000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 1.1 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 32 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 5 dBm (típico). Dimensiones del die: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 14000; Máximo: 15000; Valor: 14000–15000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Típico: 32; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

800–4000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 0.4 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 32 dB (típico) (Vd = +5 V); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 15 dBm (típico) (Vd = +5 V). Dimensiones del die: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 800; Máximo: 4000; Valor: 800–4000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 15; Valor: Vd = +5 V; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Típico: 32; Valor: Vd = +5 V; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

800–4000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 0.4 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 32 dB (típico) (Vd = +5 V); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 15 dBm (típico) (Vd = +5 V). Dimensiones del die: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 800; Máximo: 4000; Valor: 800–4000; Unidad: MHz

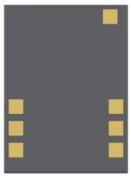
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 15; Valor: Vd = +5 V; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Típico: 32; Valor: Vd = +5 V; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-30-600-NF0p6T

30–600 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 0.6 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 32.3 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 30; Máximo: 600; Valor: 30–600; Unidad: MHz

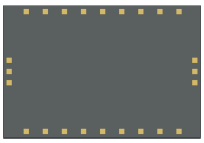
Ganancia de pequeña señal: Típico: 32.3; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±0.3; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

75000–110000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 2.8 dB (típico) (f = 90000 MHz); Figura de ruido: 3.3 dB (máximo); Ganancia de pequeña señal: 25 dB (típico) (f = 75000–90000 MHz); Ganancia de pequeña señal: 22 dB (típico) (f = 90000–110000 MHz). Dimensiones del die: 2 × 3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 75000; Máximo: 110000; Valor: 75000–110000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Típico: 25; Unidad: dB; Notas: f = 75000–90000 MHz

Ganancia de pequeña señal: Típico: 22; Unidad: dB; Notas: f = 90000–110000 MHz

Pérdida de retorno de entrada: Típico: 6; Unidad: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

17000–22000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC

Figura de ruido: 1.3 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 26 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 4 dBm (típico). Dimensiones del die: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 17000; Máximo: 22000; Valor: 17000–22000; Unidad: MHz

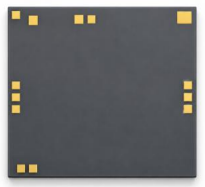
Ganancia de pequeña señal: Típico: 26; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Típico: ±0.5; Unidad: dB

Figura de ruido: Típico: 1.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3900-PS31T

Die de amplificador de potencia GaAs MMIC de 2700–3900 MHz

pulsado: PSAT: 30.5 dBm (mínimo) / 31 dBm (típico); Ganancia de potencia: 35.5 dB (mínimo) / 36 dB (típico); PAE: 45 % (mínimo) / 48 % (típico). Dimensiones del die en planta: 2.5 × 2.262 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 30.5; Típico: 31; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 35.5; Típico: 36; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

Die de amplificador de potencia GaAs MMIC de 2700–3900 MHz

pulsado: PSAT: 34 dBm (mínimo) / 34.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 29 dB (mínimo) / 29.5 dB (típico); PAE: 47 % (mínimo) / 49 % (típico). Dimensiones del die en planta: 2.2 × 3.092 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidad: MHz

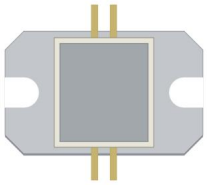
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 34; Típico: 34.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 29; Típico: 29.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-200-2200-PS41T

200–2200 MHz Amplificador de potencia GaN MMIC con encapsulado metal-cerámico

Potencia de salida saturada: 39.5 dBm (mínimo) / 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 23.5 dB (mínimo) / 25 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (mínimo) / 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 200; Máximo: 2200; Valor: 200–2200; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Mínimo: 39.5; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 23.5; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = +16 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T

8000–12000 MHz Amplificador de bajo ruido con encapsulado QFN

Figura de ruido: 0.9 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 28 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensiones del encapsulado: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 10; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Típico: 28; Unidad: dB

Figura de ruido: Típico: 0.9; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T-M

8000–12000 MHz Amplificador de bajo ruido con encapsulado QFN

Figura de ruido: 0.9 dB (típico); Ganancia de pequeña señal: 28 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensiones del encapsulado: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

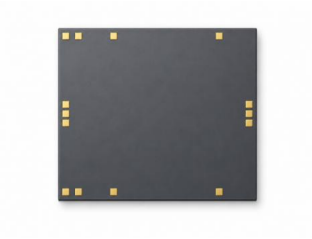
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 10; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Típico: 28; Unidad: dB

Figura de ruido: Típico: 0.9; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-18000-PS42T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 42 dBm (típico); Ganancia de potencia: 17 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 20 % (típico); Dimensiones del die: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.2; Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 16.2; Típico: 17; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS29T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 29 dBm (típico); Ganancia de potencia: 14 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 15 % (típico); Dimensiones del die: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 13; Típico: 14; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 29; Unidad: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 20.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Típico: 20.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 40.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 38 % (típico); Dimensiones del die: 2.8 × 2.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

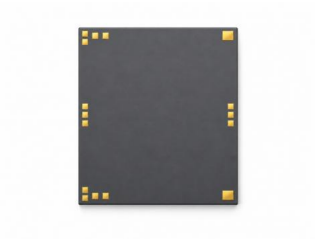
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39.5; Típico: 40.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.5; Típico: 22.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 45.8 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18.8 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 42 % (típico); Dimensiones del die: 3.17 × 3.58 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

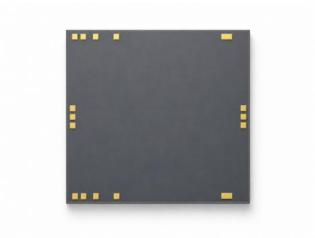
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.8; Típico: 45.8; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 17.8; Típico: 18.8; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.8; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-10000-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 4000–10000 MHz

4000–10000 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 17 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 30 % (típico); Dimensiones del die: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 10000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43.8; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 15.8; Típico: 17; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.8; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2500–6200 MHz

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 17.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 6200; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Potencia de salida saturada: 47.8 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21.8 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 47 % (típico); Dimensiones del die: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Unidad: MHz

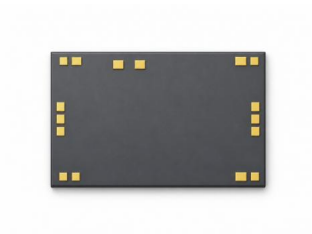
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.8; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 21.8; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 42 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 43 % (típico); Dimensiones del die: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.2; Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.2; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-18000-PS40T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganancia de potencia 12 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

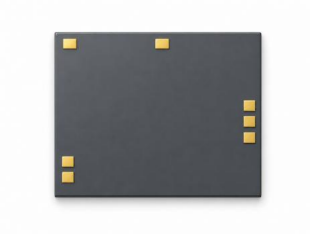
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 40; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 12; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 33.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 12 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 20 % (típico); Dimensiones del die: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

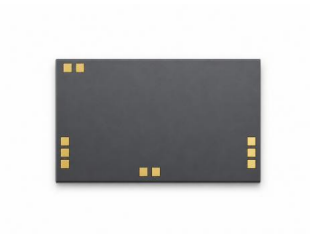
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 33; Típico: 33.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 11; Típico: 12; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-18000-PS35T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (típico); Ganancia de potencia 7 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

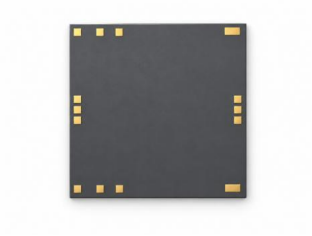
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 7; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 9200–10400 MHz

9200–10400 MHz; Potencia de salida saturada: 46.2 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24.2 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 50 % (típico); Dimensiones del die: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 9200; Máximo: 10400; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.2; Máximo: 46.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.2; Máximo: 24.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-7500-10500-PS49T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 7500–10500 MHz

7500–10500 MHz; Potencia de salida saturada: 49 dBm (típico); Ganancia de potencia: 25 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico); Dimensiones del die: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7500; Máximo: 10500; Unidad: MHz

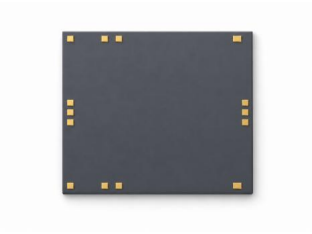
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 48.6; Típico: 49; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.6; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-7000-13000-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico); Dimensiones del die: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-18000-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 23 % (típico); Dimensiones del die: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.5; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 19.5; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 49.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 26.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 50 % (típico); Dimensiones del die: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

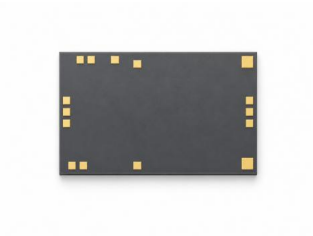
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 49; Típico: 49.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 26; Típico: 26.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-18000-PS40T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 40 dBm (típico); Ganancia de potencia: 19 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 23 % (típico); Dimensiones del die: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

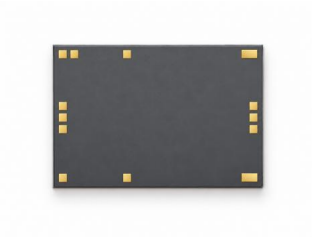
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39; Típico: 40; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 18; Típico: 19; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-10000-18000-PS41T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 10000–18000 MHz

10000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 19 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 30 % (típico); Dimensiones del die: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

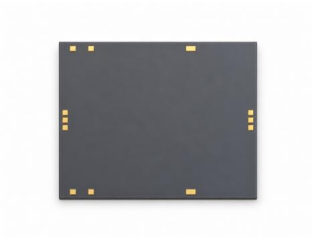
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40.9; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 18.9; Típico: 19; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-950-1250-PS47p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 950–1250 MHz

950–1250 MHz; Potencia de salida saturada: 47.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 60 % (típico); Dimensiones del die: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 950; Máximo: 1250; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 47.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 53 % (típico); Dimensiones del die: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

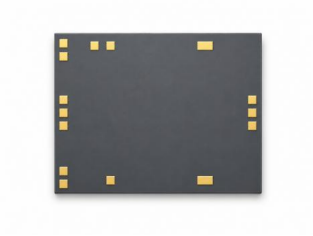
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 43.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 45 % (típico); Dimensiones del die: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 39 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 43 % (típico); Dimensiones del die: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 38; Típico: 39; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 18; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.7; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8500-10500-PS52T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Potencia de salida saturada: 52 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 45 % (típico); Dimensiones del die: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 52; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 17.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidad: MHz

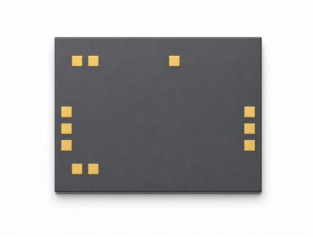
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-8000-PS37T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (típico); Ganancia de potencia 20 dB (típico); PAE 35% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidad: MHz

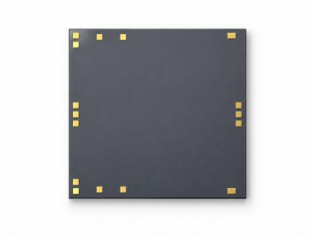
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 36.5; Típico: 37; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 19.5; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS47T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 47 dBm (típico); Ganancia de potencia: 25 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 45 % (típico); Dimensiones del die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Condiciones de ensayo RF: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

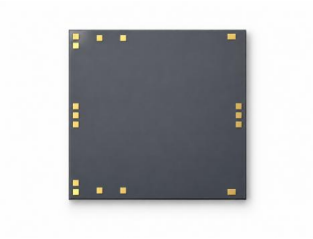
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 47 dBm (típico); Ganancia de potencia: 25 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 45 % (típico); Dimensiones del die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Condiciones de ensayo RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

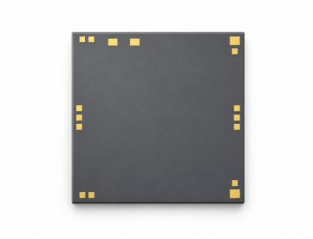
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 3600–5000 MHz

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 23.5 dB (típico); PAE 43% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 3600; Máximo: 5000; Unidad: MHz

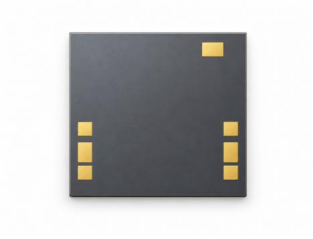
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 23; Típico: 23.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5000-13000-PS25T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 25 dBm (típico); Ganancia de potencia: 10 dB (típico); Dimensiones del die: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

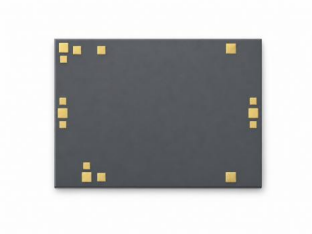
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 25; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 10; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5000-13000-PS42T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 42 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 35 % (típico); Dimensiones del die: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4200-7000-PS42T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 4200–7000 MHz

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganancia de potencia 22 dB (típico); PAE 45% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4200; Máximo: 7000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.8; Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.8; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 20.5 dB (típico); PAE 35% (típico); CW; Vd = +24 V.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

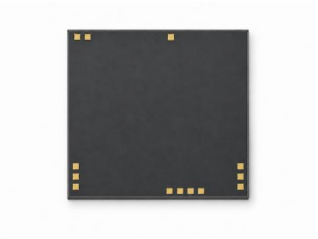
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Típico: 20.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-200-2200-PS41p5T

Chip sin encapsular amplificador de potencia GaN MMIC de 200–2200 MHz

Chip GaN sobre SiC para 200–2200 MHz, con potencia saturada típica de 41.5 dBm, ganancia de potencia típica de 25.5 dB y dimensiones de 3.00 × 3.00 × 0.10 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 200; Máximo: 2200; Unidad: MHz

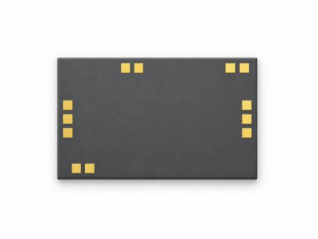
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.0; Típico: 41.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.0; Típico: 25.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.0; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-3400-5600-PS40T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 3400–5600 MHz

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganancia de potencia 17 dB (típico); PAE 46% (típico); CW.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 3400; Máximo: 5600; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39; Típico: 40; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 16; Típico: 17; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5800-6800-PS47T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 5800–6800 MHz

5800–6800 MHz; Potencia de salida saturada: 47 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 46 % (típico); Dimensiones del die: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5800; Máximo: 6800; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 25.5 dB (típico); PAE 58% (típico); CW.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Unidad: MHz

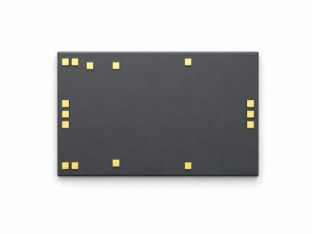
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 25; Típico: 25.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6700-7400-PS41T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6700–7400 MHz

6700–7400 MHz; Potencia de salida saturada: 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 55 % (típico); Dimensiones del die: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6700; Máximo: 7400; Unidad: MHz

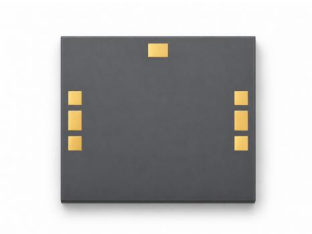
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-18000-PS27T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 27 dBm (típico); Ganancia de potencia: 9 dB (típico); Dimensiones del die: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

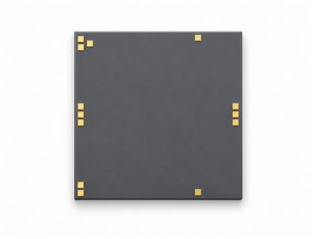
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 26; Típico: 27; Máximo: 29; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 8; Típico: 9; Máximo: 11; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-8000-PS42T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–8000 MHz

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganancia de potencia 15 dB (típico); PAE 30% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Unidad: MHz

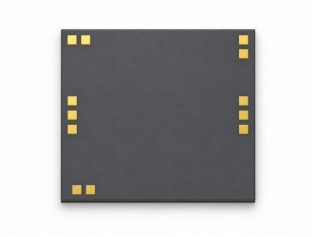
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41; Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 14; Típico: 15; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2500–3700 MHz

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 22.5 dB (típico); PAE 50% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 3700; Unidad: MHz

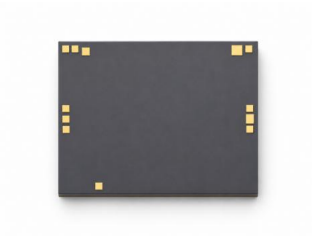
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41; Típico: 41.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2600–3300 MHz

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 25.5 dB (típico); PAE 60% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3300; Unidad: MHz

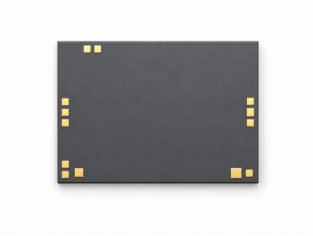
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 25; Típico: 25.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2400–3800 MHz

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 27.5 dB (típico); PAE 56% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2400; Máximo: 3800; Unidad: MHz

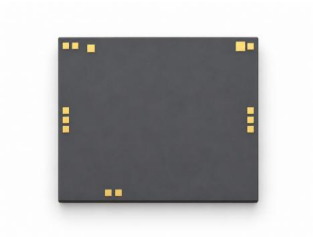
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 27; Típico: 27.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2500-4000-PS47T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2500–4000 MHz

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganancia de potencia 26 dB (típico); PAE 52% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 4000; Unidad: MHz

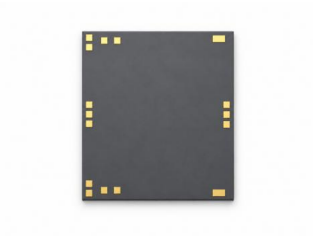
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.2; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.2; Típico: 26; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-9400-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 31 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 52 % (típico); Dimensiones del die: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Condiciones de ensayo RF: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 9400; Unidad: MHz

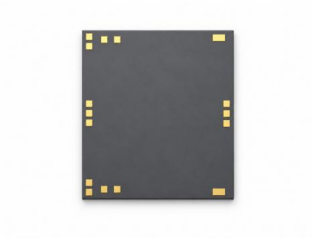
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 31; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 31 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 52 % (típico); Dimensiones del die: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Condiciones de ensayo RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 9400; Unidad: MHz

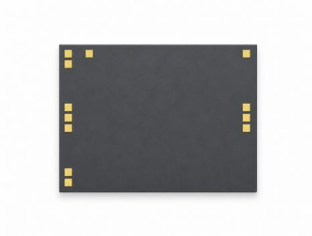
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 31; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 1200–1600 MHz

1200–1600 MHz; Potencia de salida saturada: 43.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 17 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 60 % (típico); Dimensiones del die: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 17; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 46.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 28 % (típico); Dimensiones del die: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

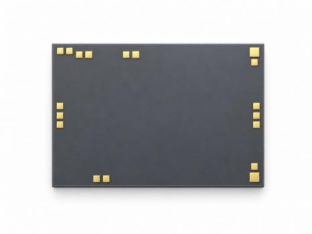
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Máximo: 47.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4400-6500-PS44T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 4400–6500 MHz

4400–6500 MHz; Potencia de salida saturada: 44 dBm (típico); Ganancia de potencia: 27 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 47 % (típico); Dimensiones del die: 3.51 × 2.44 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4400; Máximo: 6500; Unidad: MHz

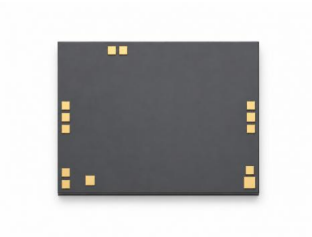
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43.5; Típico: 44; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 26.5; Típico: 27; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 26.5 dB (típico); PAE 61% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Unidad: MHz

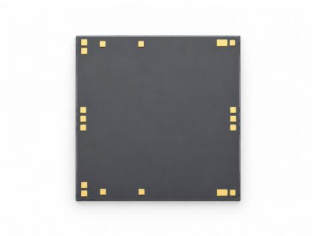
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 26; Típico: 26.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.6; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-10800-13000-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 10800–13000 MHz

10800–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 38 % (típico); Dimensiones del die: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 10800; Máximo: 13000; Unidad: MHz

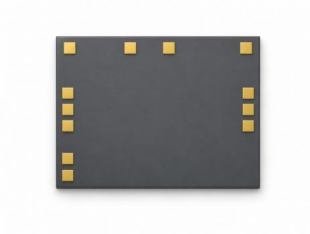
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-9000-11000-PS37T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 9000–11000 MHz

9000–11000 MHz; Potencia de salida saturada: 37 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 38 % (típico); Dimensiones del die: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 11000; Unidad: MHz

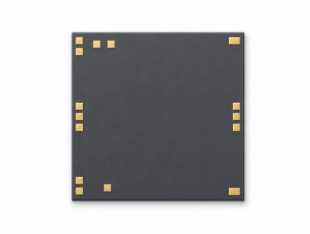
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 37; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-8400-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–8400 MHz

8000–8400 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 23 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 55 % (típico); Dimensiones del die: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 8400; Unidad: MHz

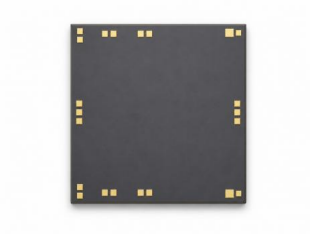
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 23; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 3700–5000 MHz

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (típico); Ganancia de potencia 27 dB (típico); PAE 48% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Unidad: MHz

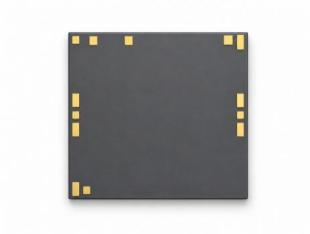
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.2; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 26.8; Típico: 27; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 43 dBm (típico); Ganancia de potencia: 26.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 50 % (típico); Dimensiones del die: 3.1 × 2.9 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidad: MHz

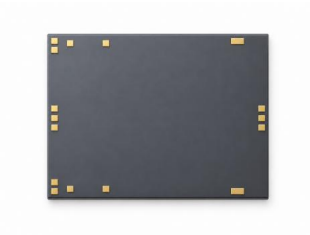
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 42.5; Típico: 43; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.5; Típico: 26.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.6; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-18000-PS44T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 44 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 30 % (típico); Dimensiones del die: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 44; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-18000-PS44T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 44 dBm (típico); Ganancia de potencia: 19 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 30 % (típico); Dimensiones del die: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

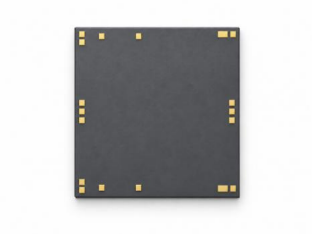
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 44; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 19; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-10000-13000-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico); Dimensiones del die: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

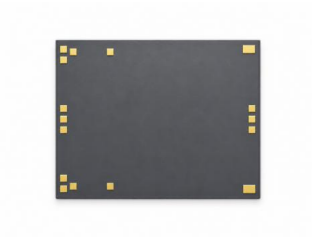
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potencia de salida saturada: 43.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 19.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 30 % (típico); Dimensiones del die: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidad: MHz

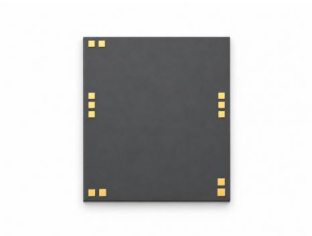
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 19.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-2800-PS41T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–2800 MHz

2000–2800 MHz; Potencia de salida saturada: 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 56 % (típico); Dimensiones del die: 2.4 × 2.7 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 2800; Unidad: MHz

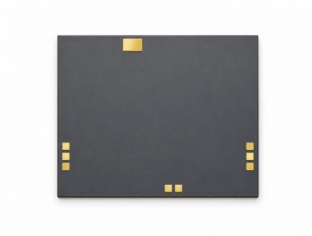
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40.7; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 23.7; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-300-6000-PS40p8T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 40.8 dBm (típico); Ganancia de potencia: 12.8 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico); Dimensiones del die: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40; Típico: 40.8; Máximo: 41.6; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 12; Típico: 12.8; Máximo: 13.6; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.8; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-18500-PS43T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2000–18500 MHz

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganancia de potencia 13 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18500; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 13; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 1950–4050 MHz

1950–4050 MHz; Potencia de salida saturada: 46.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24.5 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 52 % (típico); Dimensiones del die: 3.56 × 3.78 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 1950; Máximo: 4050; Unidad: MHz

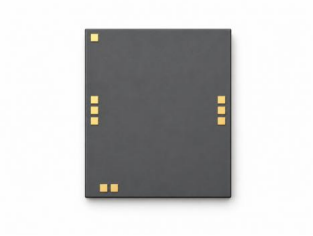
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-300-6000-PS30T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Potencia de salida saturada: 30 dBm (típico); Ganancia de potencia: 15 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 15 % (típico); Dimensiones del die: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Unidad: MHz

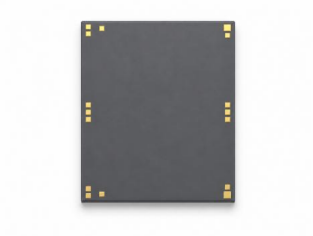
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 28; Típico: 30; Máximo: 32.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 13; Típico: 15; Máximo: 17.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3900-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 2700–3900 MHz

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (típico); Ganancia de potencia 24 dB (típico); PAE 56% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47.6; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 23.6; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.6; Unidad: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 30.5 dBm (típico); Ganancia de potencia: 30 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 22 % (típico); Dimensiones del die: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 30; Típico: 30.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 30; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-10000-13000-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 37 % (típico); Dimensiones del die: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

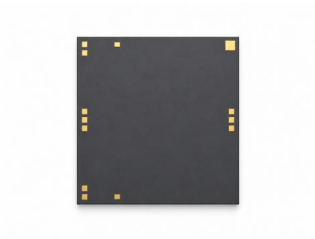
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-1200-2400-PS45T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 1200–2400 MHz

1200–2400 MHz; Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 25 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 53 % (típico); Dimensiones del die: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 2400; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.5; Típico: 45; Máximo: 45.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-12000-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6000–12000 MHz

6000–12000 MHz; Potencia de salida saturada: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico); Dimensiones del die: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-7000-13000-PS48T

Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Potencia de salida saturada: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico); Dimensiones del die: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Unidad: MHz

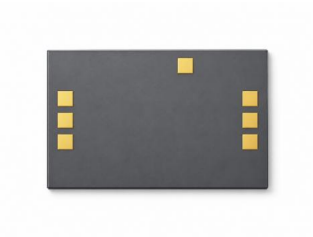
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

5000–6000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.6 dB (típico)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 28 dB (típico); P1dB 6 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

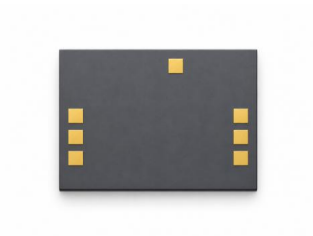
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 6; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

7000–13000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.9 dB (típico)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 22 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-7000-13000-NF1T

7000–13000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 1 dB (típico)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (típico); Ganancia de pequeña señal ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidad: MHz

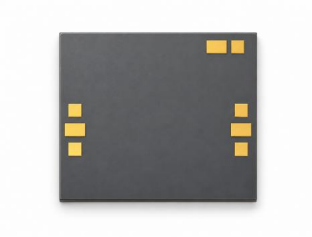
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 6; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Mínimo: 28; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

2000–6000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.8 dB (típico)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (típico); Ganancia de pequeña señal ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

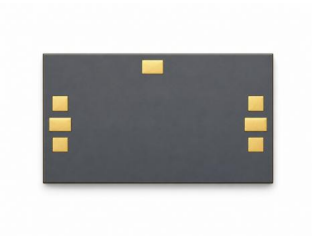
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 10; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Mínimo: 29; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

6000–18000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 22 dB (típico); P1dB 8 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

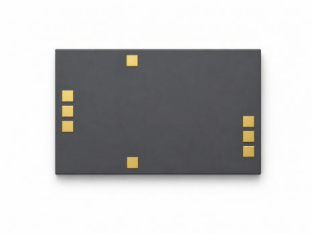
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 8; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 22; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

24000–40000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 2.5 dB (típico)

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 23 dB (típico); P1dB ≥ 11 dBm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 24000; Máximo: 40000; Valor: 24000–40000; Unidad: MHz

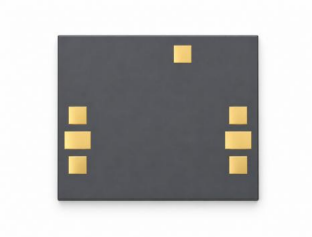
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 11; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

8000–12000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.7 dB (típico)

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 26 dB (típico); P1dB 8 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

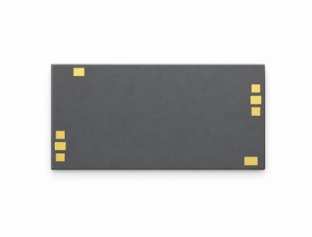
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 7; Típico: 8; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Mínimo: 25; Típico: 26; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-2000-20000-NF2T

2000–20000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 2 dB (típico)

2000–20000 MHz; NF 2 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 17 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 20000; Valor: 2000–20000; Unidad: MHz

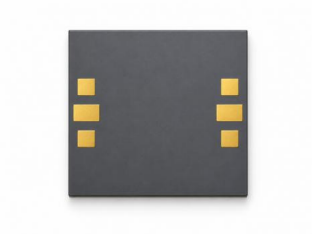
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

100–2000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 1.1 dB (típico)

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 17.5 dB (típico); P1dB 19.5 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 2000; Valor: 100–2000; Unidad: MHz

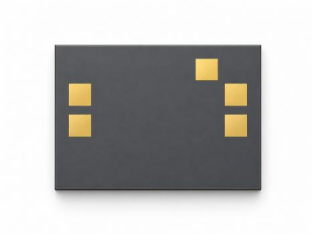
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 19.5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 17.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

800–2000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico)

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 23 dB (típico); P1dB 20.5 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidad: MHz

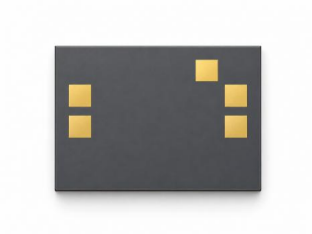
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 20.5; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 22; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-200-600-NF0p4T

200–600 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.4 dB (típico)

200–600 MHz; NF 0.4 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 28 dB (típico); P1dB 21 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 200; Máximo: 600; Valor: 200–600; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 21; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 22.5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

2000–5000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 30 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 15; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 30; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

7000–9000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.6 dB

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; Ganancia de pequeña señal 31 dB (típico); P1dB 15 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 9000; Valor: 7000–9000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 15; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 31; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

6000–20000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 26 dB (típico); P1dB -2 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 20000; Valor: 6000–20000; Unidad: MHz

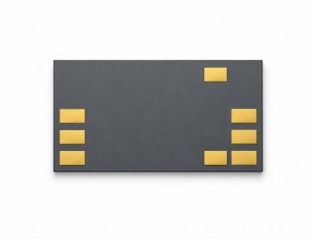
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: -4; Típico: -2; Máximo: 0; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

4000–12000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.6 dB (típico)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 34.5 dB (típico); P1dB 7 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 12000; Valor: 4000–12000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 6.5; Típico: 7; Máximo: 8.5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 34.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

2000–5000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico); P1dB 11 dBm (típico)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 30 dB (típico); P1dB 11 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidad: MHz

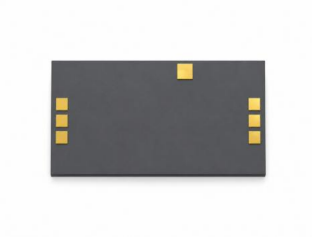
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 11; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 12; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 30; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

32000–52000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 1.8 dB (típico)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (típico); Ganancia de pequeña señal 26 dB (típico); P1dB 5 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 32000; Máximo: 52000; Valor: 32000–52000; Unidad: MHz

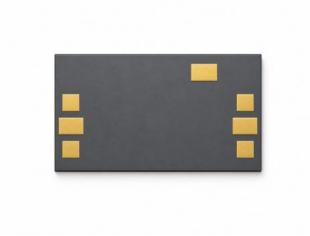
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

8000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (típico)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 24 dB (típico); NF 1.7 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

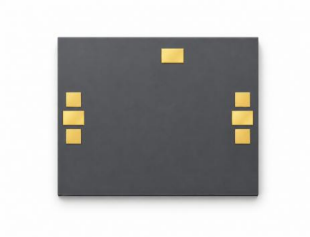
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 16; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 24; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

700–5000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 19 dBm (típico)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 14 dB (típico); NF 2.5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 5000; Valor: 700–5000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 19; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 14; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

2700–3500 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 28 dB (típico); NF 3.5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

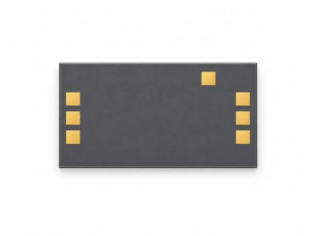
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23.5; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 25; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

14000–18000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (típico)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 19 dB (típico); NF 5.5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

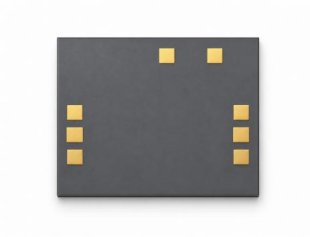
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 24; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 19; Máximo: 23; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

5000–20000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 20 dBm (típico)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 21 dB (típico); NF 6.5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 20000; Valor: 5000–20000; Unidad: MHz

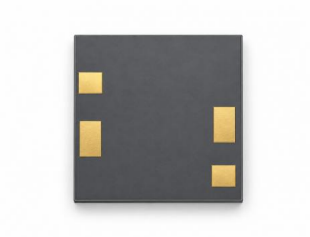
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 20; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 21; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

DC–6000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 22.8 dBm (típico)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 21 dB (típico); NF 1.8 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidad: MHz

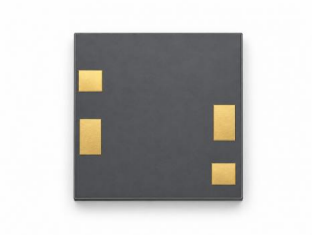
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 22.8; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

DC–6000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 21 dBm (típico)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 20 dB (típico); NF 1 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidad: MHz

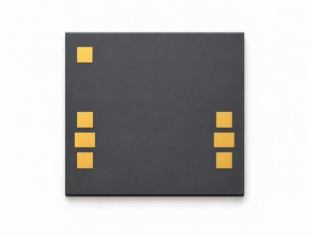
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 21; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

800–2000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 15 dBm (típico)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 17 dB (típico); NF 1.4 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidad: MHz

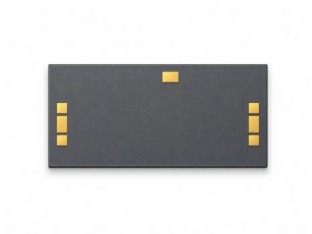
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 15; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de pequeña señal: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

2000–7000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (típico)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 21 dB (típico); NF 5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 7000; Valor: 2000–7000; Unidad: MHz

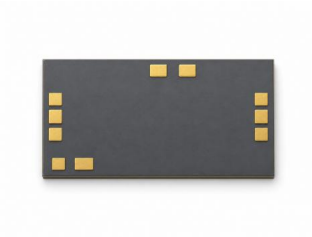
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23.5; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 24.5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-8000-12000-PS28T

8000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — PSAT 28 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 21 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

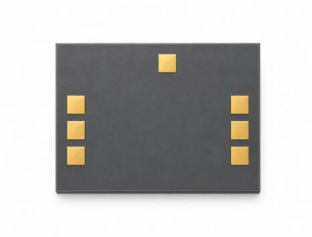
Potencia de salida saturada: Mínimo: 27.8; Típico: 28; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 19; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

4000–9000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 17 dBm (típico)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 13 dB (típico); NF 3.5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 9000; Valor: 4000–9000; Unidad: MHz

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 17; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 18; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 13; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

2000–18000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (típico)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 21 dB (típico); NF 3 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidad: MHz

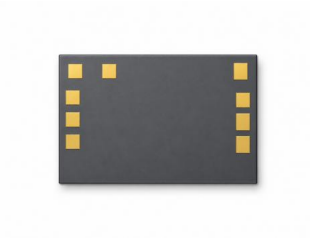
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 16; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 17; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

6000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (típico)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 23 dB (típico); NF 5 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Valor: 6000–12000; Unidad: MHz

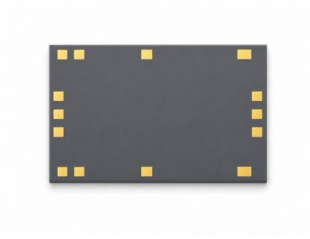
Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Valor: 23.8; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-24000-31000-PS25T

24000–31000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — PSAT 25 dBm (típico)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 22 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 24000; Máximo: 31000; Valor: 24000–31000; Unidad: MHz

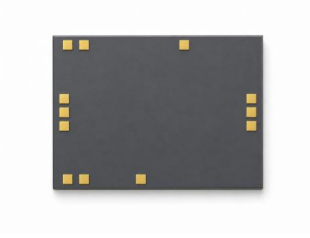
Ganancia de pequeña señal: Típico: 22; Unidad: dB

Potencia de salida saturada: Típico: 25; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 20; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

8000–18000 MHz Die amplificador bidireccional GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 24 dBm (típico)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 21 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Valor: 8000–18000; Unidad: MHz

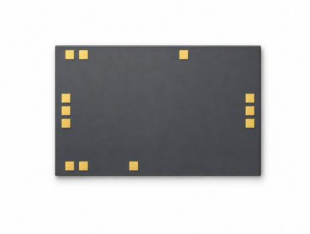
Potencia de salida en compresión de 1 dB (Rx): Típico: 24; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada (Rx): Típico: 24.5; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal (Rx): Típico: 21; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

6000–18000 MHz Die amplificador bidireccional GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 21 dBm (típico)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (típico); Ganancia de pequeña señal 19 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

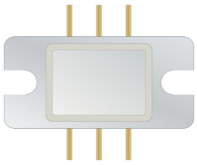
Potencia de salida en compresión de 1 dB (Rx): Típico: 21; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada (Rx): Típico: 22; Unidad: dBm

Ganancia de pequeña señal (Rx): Típico: 19; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS40T

2000–6000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 40 dBm (típico)

2000–6000 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganancia de potencia 22 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

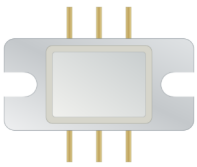
Potencia de salida saturada: Mínimo: 39.5; Típico: 40; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 21.5; Típico: 22; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 32; Típico: 38; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-7500-10500-PS48T

7500–10500 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 48 dBm (típico)

7500–10500 MHz; PSAT 48 dBm (típico); Ganancia de potencia 24 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7500; Máximo: 10500; Valor: 7500–10500; Unidad: MHz

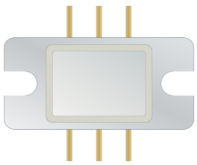
Potencia de salida saturada: Mínimo: 47.5; Típico: 48; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 23.5; Típico: 24; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 32; Típico: 40; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; D = 10%; Pin = 24 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-8500-PS41T

2000–8500 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 41 dBm (típico)

2000–8500 MHz; PSAT 41 dBm (típico); Ganancia de potencia 15 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8500; Valor: 2000–8500; Unidad: MHz

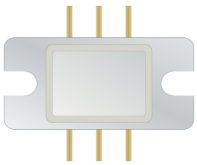
Potencia de salida saturada: Mínimo: 40.3; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 14.3; Típico: 15; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 25; Típico: 35; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2500-6200-PS44p5T

2500–6200 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

2500–6200 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 16.5 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 6200; Valor: 2500–6200; Unidad: MHz

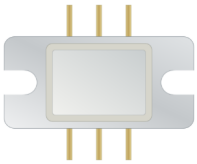
Potencia de salida saturada: Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 16; Típico: 16.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 35; Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5000-6000-PS47T

5000–6000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 47 dBm (típico)

5000–6000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganancia de potencia 24 dB (típico); PAE 56 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

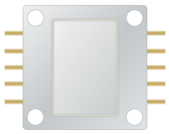
Potencia de salida saturada: Mínimo: 46.2; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 23.2; Típico: 24; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 50; Típico: 56; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 5%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13400-14600-PS44p5T

13400–14600 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

13400–14600 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 19.5 dB (típico); PAE 32 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 13400; Máximo: 14600; Valor: 13400–14600; Unidad: MHz

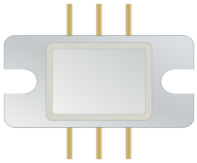
Potencia de salida saturada: Mínimo: 43.7; Típico: 44.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 19.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 28; Típico: 32; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5000-6000-PS49T

5000–6000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 49 dBm (típico)

5000–6000 MHz; PSAT 49 dBm (típico); Ganancia de potencia 26 dB (típico); PAE 53 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

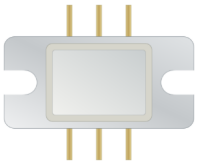
Potencia de salida saturada: Mínimo: 48.5; Típico: 49; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 25.5; Típico: 26; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 51; Típico: 53; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2500-3700-PS41T

2500–3700 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 41 dBm (típico)

2500–3700 MHz; PSAT 41 dBm (típico); Ganancia de potencia 22 dB (típico); PAE 47 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 3700; Valor: 2500–3700; Unidad: MHz

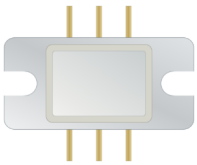
Potencia de salida saturada: Mínimo: 40.5; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 21.5; Típico: 22; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 42; Típico: 47; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-13600-14500-PS41MIN

13600–14500 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 41 dBm

13600–14500 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; Ganancia de potencia ≥ 20 dB; PAE 37 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 13600; Máximo: 14500; Valor: 13600–14500; Unidad: MHz

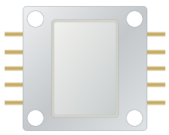
Potencia de salida saturada: Mínimo: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 20; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 32; Típico: 37; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-6000-12000-PS46T

6000–12000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 46 dBm (típico)

6000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (típico); Ganancia de potencia 22 dB (típico); PAE 30 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Valor: 6000–12000; Unidad: MHz

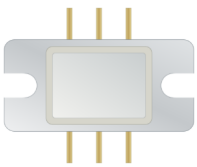
Potencia de salida saturada: Típico: 46; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 22; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 30; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4200-7000-PS41MIN

4200–7000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 41 dBm

4200–7000 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; Ganancia de potencia ≥ 21 dB; PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4200; Máximo: 7000; Valor: 4200–7000; Unidad: MHz

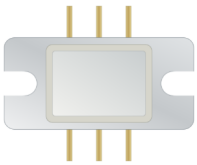
Potencia de salida saturada: Mínimo: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 21; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 40; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-5000-PS45MIN

4000–5000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 45 dBm

4000–5000 MHz; PSAT ≥ 45 dBm; Ganancia de potencia ≥ 26 dB; PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 5000; Valor: 4000–5000; Unidad: MHz

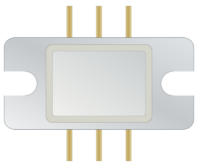
Potencia de salida saturada: Mínimo: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 26; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 40; Típico: 50; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-1200-1600-PS42MIN

1200–1600 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 42 dBm

1200–1600 MHz; PSAT ≥ 42 dBm; Ganancia de potencia ≥ 16 dB; PAE 55 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidad: MHz

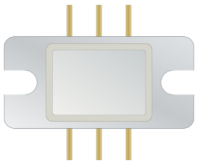
Potencia de salida saturada: Mínimo: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 16; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 55; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -1.8; D = 10%; Pin = 26 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2500-4000-PS46p5T

2500–4000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 46.5 dBm (típico)

2500–4000 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 26.5 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 4000; Valor: 2500–4000; Unidad: MHz

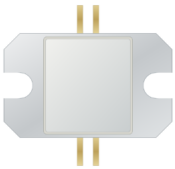
Potencia de salida saturada: Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 25; Típico: 26.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-C

2700–3500 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 45.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 26.5 dB (típico); PAE 55 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

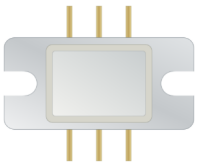
Potencia de salida saturada: Mínimo: 44.5; Típico: 45.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 25.5; Típico: 26.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 50; Típico: 55; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-8000-PS43T

4000–8000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 43 dBm (típico)

4000–8000 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganancia de potencia 20 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Valor: 4000–8000; Unidad: MHz

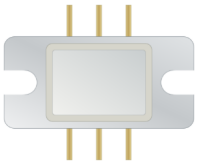
Potencia de salida saturada: Mínimo: 42; Típico: 43; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 19; Típico: 20; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 30; Típico: 35; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 23 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-3400-4800-PS43T

3400–4800 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 43 dBm (típico)

3400–4800 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganancia de potencia 23 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 3400; Máximo: 4800; Valor: 3400–4800; Unidad: MHz

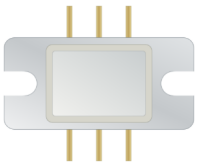
Potencia de salida saturada: Mínimo: 42; Típico: 43; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 22; Típico: 23; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 35; Típico: 45; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-9200-10400-PS45T

9200–10400 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 45 dBm (típico)

9200–10400 MHz; PSAT 45 dBm (típico); Ganancia de potencia 23 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 9200; Máximo: 10400; Valor: 9200–10400; Unidad: MHz

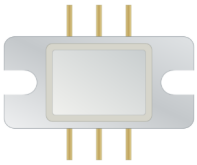
Potencia de salida saturada: Mínimo: 44.7; Típico: 45; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 22.7; Típico: 23; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 35; Típico: 38; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-8000-PS42p5T

2000–8000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 42.5 dBm (típico)

2000–8000 MHz; PSAT 42.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 15.5 dB (típico); PAE 28 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Valor: 2000–8000; Unidad: MHz

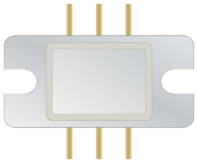
Potencia de salida saturada: Mínimo: 40; Típico: 42.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 13; Típico: 15.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 25; Típico: 28; Unidad: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-5800-6800-PS46p5T

5800–6800 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 46.5 dBm (típico)

5800–6800 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 21 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5800; Máximo: 6800; Valor: 5800–6800; Unidad: MHz

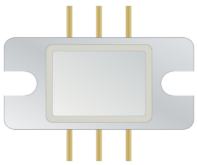
Potencia de salida saturada: Mínimo: 45.5; Típico: 46.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 20; Típico: 21; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 26 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS44p5T

2000–6000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

2000–6000 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 17.5 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

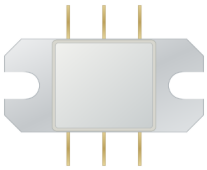
Potencia de salida saturada: Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 30; Típico: 35; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 27 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS42T-C

8000–12000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 42 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganancia de potencia 21 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

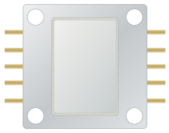
Potencia de salida saturada: Típico: 42; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 21; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 38; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 21 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS46T

8000–12000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 46 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (típico); Ganancia de potencia 24 dB (típico); PAE 37 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

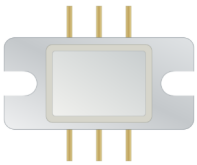
Potencia de salida saturada: Típico: 46; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Típico: 24; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 37; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-8000-PS36p5T

4000–8000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 36.5 dBm (típico)

4000–8000 MHz; PSAT 36.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 19.5 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Valor: 4000–8000; Unidad: MHz

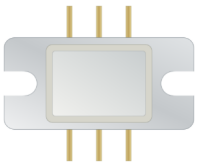
Potencia de salida saturada: Mínimo: 36; Típico: 36.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 30; Típico: 35; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-4000-8000-PS47T

4000–8000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 47 dBm (típico)

4000–8000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganancia de potencia 19 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Valor: 4000–8000; Unidad: MHz

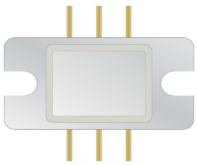
Potencia de salida saturada: Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 18.5; Típico: 19; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 32; Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 28 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2000-6000-PS43T-C

2000–6000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 43 dBm (típico)

2000–6000 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganancia de potencia 26 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

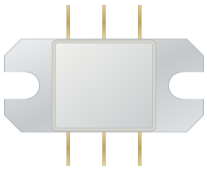
Potencia de salida saturada: Mínimo: 42.5; Típico: 43; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 25.5; Típico: 26; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 35; Típico: 45; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-8000-12000-PS39T-C

8000–12000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 39 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 39 dBm (típico); Ganancia de potencia 18 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

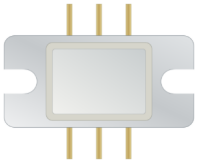
Potencia de salida saturada: Mínimo: 37; Típico: 39; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 17; Típico: 18; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-9000-11000-PS36MIN

9000–11000 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 36 dBm

9000–11000 MHz; PSAT ≥ 36 dBm; Ganancia de potencia ≥ 23 dB; PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 11000; Valor: 9000–11000; Unidad: MHz

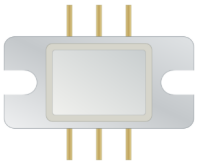
Potencia de salida saturada: Mínimo: 36; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 23; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 33; Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 13 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-2700-3500-PS31p5T

2700–3500 MHz GaAs Amplificador de potencia encapsulado — PSAT 31.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 31.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 36.5 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

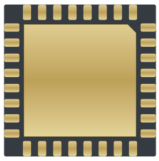
Potencia de salida saturada: Mínimo: 31; Típico: 31.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 36; Típico: 36.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 37; Típico: 40; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 8 V; VGS ∈ [-0.8, -0.6] V; Pin = -5 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PA-10-1100-PS40MIN

10–1100 MHz GaN Amplificador de potencia encapsulado — PSAT ≥ 40 dBm

10–1100 MHz; PSAT ≥ 40 dBm; Ganancia de potencia ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 10; Máximo: 1100; Valor: 10–1100; Unidad: MHz

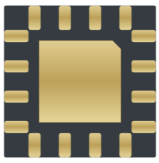
Potencia de salida saturada: Mínimo: 40; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 13; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 60; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-4000-12000-NF0p8T

4000–12000 MHz Amplificador de bajo ruido encapsulado — NF 0.8 dB (típico)

4000–12000 MHz; Ganancia de pequeña señal 34 dB (típico); Figura de ruido 0.8 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 7 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 12000; Valor: 4000–12000; Unidad: MHz

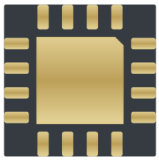
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 34; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 0.8; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 7; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB10p5T

2000–5000 MHz Amplificador de bajo ruido encapsulado — NF 0.65 dB (típico)

2000–5000 MHz; Ganancia de pequeña señal 29 dB (típico); Figura de ruido 0.65 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 10.5 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidad: MHz

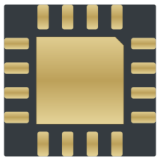
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 29; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 0.65; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 10.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB14T

2000–5000 MHz Amplificador de bajo ruido encapsulado — NF 0.65 dB (típico)

2000–5000 MHz; Ganancia de pequeña señal 29 dB (típico); Figura de ruido 0.65 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 14 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidad: MHz

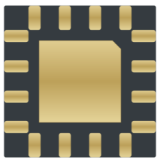
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 29; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 0.65; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 14; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG26T

8000–12000 MHz Amplificador de bajo ruido encapsulado — NF 0.9 dB (típico)

8000–12000 MHz; Ganancia de pequeña señal 26 dB (típico); Figura de ruido 0.9 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB ≥ 7 dBm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

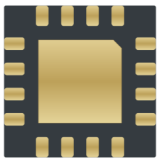
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 0.9; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Mínimo: 7; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -30 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LNA-6000-20000-NF1p5T

6000–20000 MHz Amplificador de bajo ruido encapsulado — NF 1.5 dB (típico)

6000–20000 MHz; Ganancia de pequeña señal 26 dB (típico); Figura de ruido 1.5 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB -2 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 20000; Valor: 6000–20000; Unidad: MHz

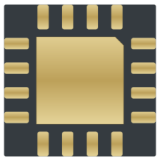
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 1.5; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: -2; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23T

2000–7000 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 23 dBm (típico)

2000–7000 MHz; Ganancia de pequeña señal 20 dB (típico); Figura de ruido 6 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 23 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 7000; Valor: 2000–7000; Unidad: MHz

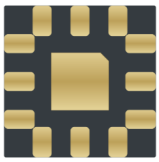
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 6; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-100-6000-P1DB20T

100–6000 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 20 dBm (típico)

100–6000 MHz; Ganancia de pequeña señal 17 dB (típico); Figura de ruido 1.2 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 20 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 1.2; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 20; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-100-6000-P1DB22T

100–6000 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 22 dBm (típico)

100–6000 MHz; Ganancia de pequeña señal 20 dB (típico); Figura de ruido 2 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 22 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidad: MHz

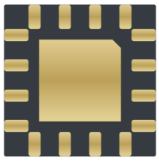
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 2; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 22; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-800-2000-P1DB14p5T

800–2000 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 14.5 dBm (típico)

800–2000 MHz; Ganancia de pequeña señal 16.5 dB (típico); Figura de ruido 1.6 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 14.5 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidad: MHz

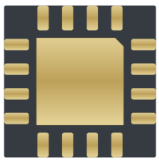
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 16.5; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 1.6; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 14.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23T

2700–3500 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 23 dBm (típico)

2700–3500 MHz; Ganancia de pequeña señal 27 dB (típico); Figura de ruido 4 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 23 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

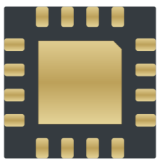
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 27; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 4; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-5000-20000-P1DB19p5T

5000–20000 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 19.5 dBm (típico)

5000–20000 MHz; Ganancia de pequeña señal 20 dB (típico); Figura de ruido 6 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 19.5 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 20000; Valor: 5000–20000; Unidad: MHz

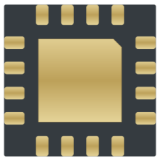
Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidad: dB

Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 6; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 19.5; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-C

14000–18000 MHz Amplificador de ganancia RF encapsulado — P1dB 23 dBm (típico)

14000–18000 MHz; Ganancia de pequeña señal 18 dB (típico); Figura de ruido 6 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB 23 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal: Símbolo: Gain; Típico: 18; Unidad: dB

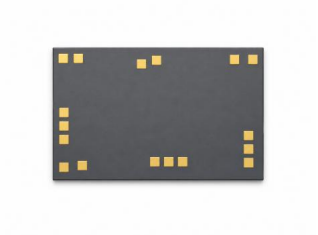
Figura de ruido: Símbolo: NF; Típico: 6; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidad: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto

CI de front-end RF



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18 dB (típico); PAE: 30 % (típico). Dimensiones del die: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidad: MHz

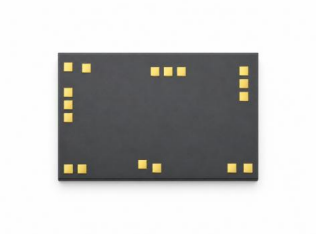
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 31; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (típico); Ganancia de potencia: 18 dB (típico); PAE: 30 % (típico). Dimensiones del die: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidad: MHz

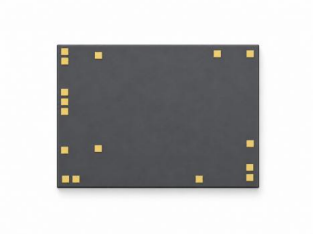
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 31; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 25 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensiones del die: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

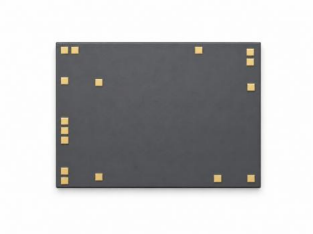
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 25 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensiones del die: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

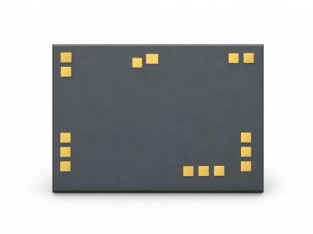
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 25; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensiones del die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 10000; Valor: 9000–10000; Unidad: MHz

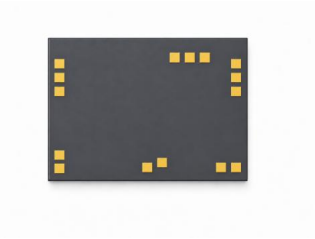
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (típico); Ganancia de potencia: 21 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensiones del die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 10000; Valor: 9000–10000; Unidad: MHz

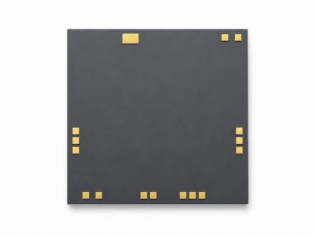
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TRPA-300-6000-PS39T

Die de amplificador de potencia GaN T/R MMIC de 300–6000 MHz

pulsado: PSAT: 38.7 dBm (mínimo) / 39 dBm (típico) / 40.5 dBm (máximo); Ganancia de potencia: 10.7 dB (mínimo) / 11 dB (típico) / 12.5 dB (máximo); PAE: 30 % (mínimo) / 35 % (típico) / 53 % (máximo). Dimensiones del die: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Valor: 300–6000; Unidad: MHz

Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 38.7; Típico: 39; Máximo: 40.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Símbolo: Gp; Mínimo: 10.7; Típico: 11; Máximo: 12.5; Unidad: dB

Planitud de la ganancia de potencia: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.9; Unidad: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; pulsado

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

8000–12000 MHz Die de frontal RF GaAs MMIC con control de amplitud y fase

Paso de fase: 5.625 °; Rango de atenuación: 0–31.5 dB; Potencia de salida en compresión de 1 dB: 11 dBm (mínimo) / 13 dBm (típico). Dimensiones del die: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

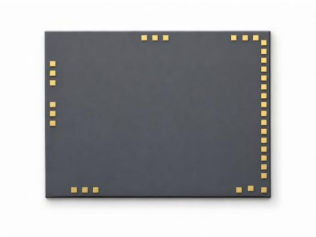
Ganancia de pequeña señal: Mínimo: 7.5; Máximo: 10; Valor: TX / RX; Unidad: dB

Aislamiento: Mínimo: 35; Unidad: dB

Rango de atenuación: Valor: 0–31.5; Unidad: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-APC-7000-13000

7000–13000 MHz Die de frontal RF GaAs MMIC con control de amplitud y fase

Paso de fase: 5.625 ° (típico); Rango de atenuación: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo); Ganancia de pequeña señal: 12 dB (típico) (RX). Dimensiones del die: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidad: MHz

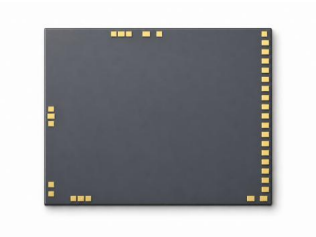
Ganancia de pequeña señal: Típico: 12; Valor: RX; Unidad: dB

Potencia de salida en compresión de 1 dB: Típico: 11; Valor: RX; Unidad: dBm

Potencia de salida saturada: Típico: 24; Valor: TX; Unidad: dBm

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-APC-5000-6000

5000–6000 MHz Die de frontal RF GaAs MMIC con control de amplitud y fase — Rx 13 dB / Tx 27 dB (típico)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (típico); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

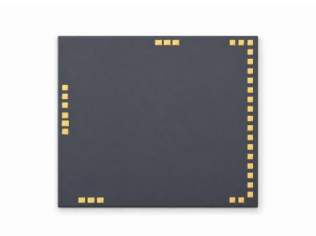
Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Rango de atenuación: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidad: dB

Ganancia de pequeña señal (Rx): Típico: 13; Unidad: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

8000–12000 MHz Die de frontal RF GaAs MMIC con control de amplitud y fase — Rx 10 dB / Tx 26 dB (típico)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (típico); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

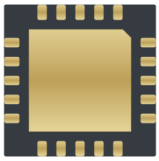
Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Rango de atenuación: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidad: dB

Ganancia de pequeña señal (Rx): Típico: 10; Unidad: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB23T

8000–18000 MHz IC de frontal RF bidireccional — RX / TX P1dB 23 dBm (típico)

8000–18000 MHz; Ganancia de pequeña señal (Rx) 20 dB (típico); Ganancia de pequeña señal (Tx) 20 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB (Rx) 23 dBm (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB (Tx) 23 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Valor: 8000–18000; Unidad: MHz

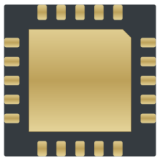
Ganancia de pequeña señal (Rx): Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidad: dB; Notas: RX

Ganancia de pequeña señal (Tx): Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidad: dB; Notas: TX

Potencia de salida en compresión de 1 dB (Rx): Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidad: dBm; Notas: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB20T

6000–18000 MHz IC de frontal RF bidireccional — RX / TX P1dB 20 dBm (típico)

6000–18000 MHz; Ganancia de pequeña señal (Rx) 18 dB (típico); Ganancia de pequeña señal (Tx) 18 dB (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB (Rx) 20 dBm (típico); Potencia de salida en compresión de 1 dB (Tx) 20 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

Ganancia de pequeña señal (Rx): Símbolo: Gain; Típico: 18; Unidad: dB; Notas: RX

Ganancia de pequeña señal (Tx): Símbolo: Gain; Típico: 18; Unidad: dB; Notas: TX

Potencia de salida en compresión de 1 dB (Rx): Símbolo: P_1; Típico: 20; Unidad: dBm; Notas: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Dispositivos RF bare die y chip-scale



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nivel de limitación: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 1 ms; D = 20%). Dimensiones del die: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidad: MHz

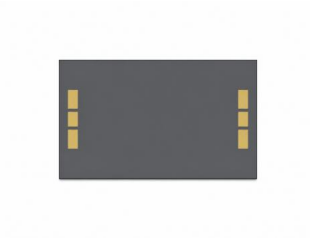
Pérdida de inserción: Típico: 0.6; Máximo: 0.7; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de salida: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.45 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nivel de limitación: 18.5 dBm (típico) / 19.5 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 49 dBm (máximo) (τ = 2 ms; D = 20%); Potencia máxima de entrada pulsada: 50 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.45; Máximo: 0.5; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.5 dB (típico); Nivel de limitación: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 42 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

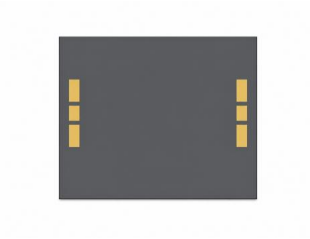
Pérdida de inserción: Típico: 0.5; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.3 dB (típico) / 0.4 dB (máximo); Nivel de limitación: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 200 µs; D = 20%). Dimensiones del die: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

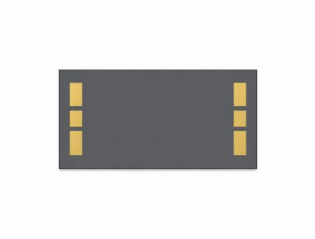
Pérdida de inserción: Típico: 0.3; Máximo: 0.4; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de salida: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.8 dB (típico); Nivel de limitación: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 42 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

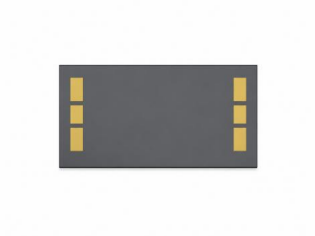
Pérdida de inserción: Típico: 0.8; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6

VSWR de salida: Típico: 1.6

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.6 dB (típico); Nivel de limitación: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 41 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.6; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.5

VSWR de salida: Típico: 1.5

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.8 dB (típico); Nivel de limitación: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 48 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%); Potencia de entrada máxima: 46 dBm (máximo) (CW). Dimensiones del die: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.8; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.5

VSWR de salida: Típico: 1.5

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.4 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nivel de limitación: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potencia de entrada máxima: 37 dBm (máximo) (CW). Dimensiones del die: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 14000; Valor: DC–14000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.4; Máximo: 0.5; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nivel de limitación: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.6; Máximo: 0.7; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6

VSWR de salida: Típico: 1.6

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.3 dB (típico); Nivel de limitación: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 37 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.3; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.3 dB (típico); Nivel de limitación: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 37 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.3; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.8 dB (típico); Nivel de limitación: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 200 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 10000; Máximo: 18000; Valor: 10000–18000; Unidad: MHz

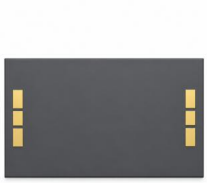
Pérdida de inserción: Típico: 0.8; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6; Máximo: 1.8

VSWR de salida: Típico: 1.6; Máximo: 1.8

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.35 dB (típico) / 0.4 dB (máximo); Nivel de limitación: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensiones del die: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.35; Máximo: 0.4; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4; Máximo: 1.5

VSWR de salida: Típico: 1.4; Máximo: 1.5

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.4 dB (típico); Nivel de limitación: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 51 dBm (máximo) (τ = 100 µs; D = 10%); Potencia de entrada máxima: 48 dBm (máximo) (CW). Dimensiones del die: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 4000; Valor: 2000–4000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.4; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-R15OHM

15 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 15 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.35 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.8 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 1

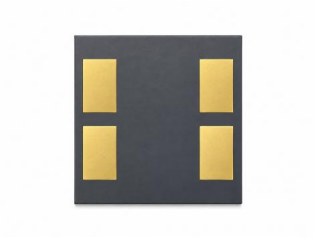
Número de terminales: Valor: 2

Resistencia: Típico: 15; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 20 / 20 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.165 / 0.165 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.33 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 2

Número de terminales: Valor: 4

Resistencia: Típico: 20 / 20; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-R50OHM

50 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 50 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.2 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.6 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 1

Número de terminales: Valor: 2

Resistencia: Típico: 50; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Chip resistor de película delgada de GaAs

Resistencia: 1000 Ω (típico); Corriente de funcionamiento lineal: 0.04 A (típico); Corriente máxima admisible: 0.08 A (máximo). Dimensiones del die en planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistencias: Valor: 1

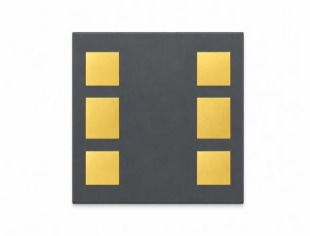
Número de terminales: Valor: 2

Resistencia: Típico: 1000; Unidad: Ω

Tolerancia de resistencia: Típico: ±5; Unidad: %

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCCAP-C10PF

10 pF Chip condensador de GaAs

Capacitancia: 10 pF (típico); Tensión soportada: 50 V (típico). Dimensiones del die: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Capacitancia: Típico: 10; Unidad: pF; TA = +25 °C

Tensión soportada: Típico: 50; Unidad: V; TA = +25 °C

Tensión de ruptura: Valor: 80 (Vb); Unidad: V

Temperatura de almacenamiento: Mínimo: -65; Máximo: 150; Unidad: °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz Chip ecualizador de pendiente GaAs

Magnitud de ecualización: 2 dB; Pérdida de inserción @ 8000 MHz: 2.6 dB; Pérdida de inserción @ 12000 MHz: 0.7 dB. Dimensiones del die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

Magnitud de ecualización: Valor: 2; Unidad: dB

Pérdida de inserción @ 8000 MHz: Valor: 2.6; Unidad: dB

Pérdida de inserción @ 12000 MHz: Valor: 0.7; Unidad: dB

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz Chip ecualizador de pendiente GaAs

Magnitud de ecualización: 5.5 dB; Pérdida de inserción @ 2000 MHz: 0.6 dB; Pérdida de inserción @ 6000 MHz: 6.1 dB. Dimensiones del die: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

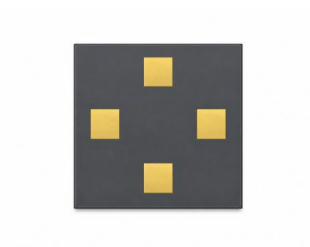
Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

Magnitud de ecualización: Valor: 5.5; Unidad: dB

Pérdida de inserción @ 2000 MHz: Valor: 0.6; Unidad: dB

Pérdida de inserción @ 6000 MHz: Valor: 6.1; Unidad: dB

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz Chip de cruce RF GaAs

Pérdida de inserción: 0.4 dB (típico); Aislamiento: 30 dB (típico); Pérdida de retorno: 20 dB (típico). Dimensiones del die: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 40000; Valor: DC–40000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 0.4; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

Pérdida de retorno: Típico: 20; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCBPF-17000-19000

17000–19000 MHz GaAs Die de filtro pasabanda — IL 2.7 dB (típico)

17000–19000 MHz; Pérdida de inserción 2.7 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 17000; Máximo: 19000; Valor: 17000–19000; Unidad: MHz

Frecuencia central: Típico: 18000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 2.7; Unidad: dB

Rizado en banda pasante: Típico: 0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Circuitos integrados de conmutación RF



LCI-SW-1000-12000-SPDT

1000–12000 MHz GaN Die conmutador SPDT MMIC

Pérdida de inserción: 1 dB (típico); Aislamiento: 34 dB (mínimo) / 63 dB (máximo); Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: 43 dBm (típico). Dimensiones del die: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 1000; Máximo: 12000; Valor: 1000–12000; Unidad: MHz

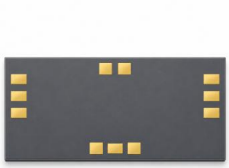
Pérdida de inserción: Típico: 1; Unidad: dB

Aislamiento: Mínimo: 34; Máximo: 63; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 43; Unidad: dBm

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-12000-18000-SPDT

12000–18000 MHz GaN Die conmutador SPDT MMIC — IL 1 dB (típico)

12000–18000 MHz; Pérdida de inserción 1 dB (típico); Aislamiento 38 dB (típico); P0.2dB 44 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 1; Máximo: 1.2; Unidad: dB

Aislamiento: Mínimo: 36; Típico: 38; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 44; Unidad: dBm

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-32000-38000-SPDT

32000–38000 MHz Die conmutador SPDT MMIC — IL 1 dB (típico)

32000–38000 MHz; Pérdida de inserción 1 dB (típico); Aislamiento 20 dB (típico); P0.2dB 42 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 32000; Máximo: 38000; Valor: 32000–38000; Unidad: MHz

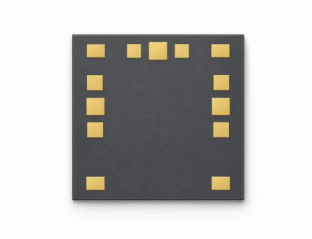
Pérdida de inserción: Típico: 1; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 42; Unidad: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-2000-18000-SPDT

2000–18000 MHz Die conmutador SPDT MMIC — IL 0.9 dB (típico)

2000–18000 MHz; Pérdida de inserción 0.9 dB (típico); Aislamiento 23 dB (típico); P0.2dB 37 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidad: MHz

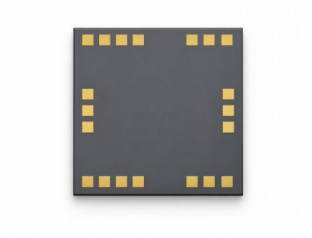
Pérdida de inserción: Típico: 0.9; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 23; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 37; Unidad: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SP3T-D

100–20000 MHz GaAs Die conmutador SP3T MMIC — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Pérdida de inserción (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; Aislamiento (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción (100–2000 MHz): Máximo: 1.4; Valor: f = 100–2000 MHz; Unidad: dB

Pérdida de inserción (2000–20000 MHz): Máximo: 2.8; Valor: f = 2000–20000 MHz; Unidad: dB

Aislamiento (100–2000 MHz): Máximo: 65; Valor: f = 100–2000 MHz; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

100–20000 MHz GaAs Die conmutador SPDT MMIC — IL 1.6 dB (típico)

100–20000 MHz; Pérdida de inserción 1.6 dB (típico); Aislamiento 45 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz; TA = +25 °C

Pérdida de inserción: Típico: 1.6; Unidad: dB; TA = +25 °C

Aislamiento: Típico: 45; Unidad: dB; TA = +25 °C

Corriente de reposo de alimentación negativa: Típico: 0.0012; Unidad: A

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-8000-12000-SPDT

8000–12000 MHz GaN Die conmutador SPDT MMIC — IL 0.9 dB (típico)

8000–12000 MHz; Pérdida de inserción 0.9 dB (típico); Aislamiento 45 dB (típico); P0.2dB 46 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

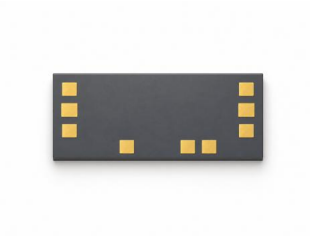
Pérdida de inserción: Típico: 0.9; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 45; Máximo: 50; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 46; Unidad: dBm

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SPST-D

100–20000 MHz GaAs Die conmutador SPST MMIC — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; Pérdida de inserción ≤ 1.2 dB; Aislamiento 60 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Máximo: 1.2; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 60; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida (conducción): Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-2700-3500-SPDT

2700–3500 MHz GaN Die conmutador SPDT MMIC — IL 0.7 dB (típico)

2700–3500 MHz; Pérdida de inserción 0.7 dB (típico); Aislamiento 41 dB (típico); P0.2dB 51 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

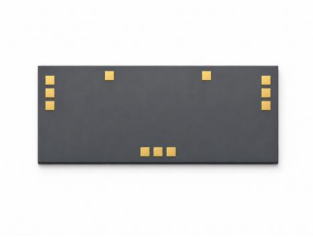
Pérdida de inserción: Típico: 0.7; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 41; Máximo: 43; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 51; Unidad: dBm

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-6000-SPDT

100–6000 MHz GaN Die conmutador SPDT MMIC — IL 0.7 dB (típico)

100–6000 MHz; Pérdida de inserción 0.7 dB (típico); Aislamiento 45 dB (típico); P0.2dB 47 dBm (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidad: MHz

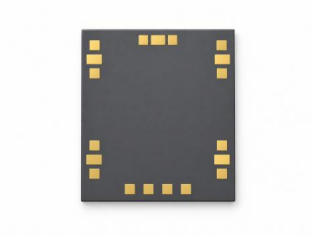
Pérdida de inserción: Típico: 0.7; Máximo: 0.8; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 45; Unidad: dB

Potencia de entrada en compresión de 0.2 dB: Típico: 47; Unidad: dBm

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SP4T-D

100–20000 MHz GaAs Die conmutador SP4T MMIC — IL −2 dB (típico)

100–20000 MHz; Pérdida de inserción -2 dB (típico); Aislamiento -50 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

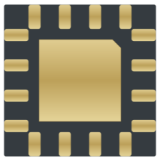
Pérdida de inserción: Típico: -2; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: -50; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SPST-C

100–20000 MHz IC conmutador RF — SPST; TTL

100–20000 MHz; SPST; Pérdida de inserción -1.8 dB (típico); Aislamiento 60 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

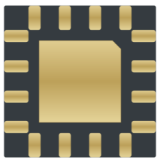
Pérdida de inserción: Símbolo: IL; Típico: -1.8; Unidad: dB

Aislamiento: Símbolo: ISO; Típico: 60; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida (conducción): Típico: 1.14

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SP3T-C

100–20000 MHz IC conmutador RF — SP3T; TTL

100–20000 MHz; SP3T; Pérdida de inserción -3.1 dB (típico); Aislamiento 50 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

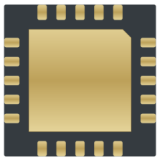
Pérdida de inserción: Símbolo: IL; Típico: -3.1; Unidad: dB

Aislamiento: Símbolo: ISO; Típico: 50; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida (conducción): Típico: 1.14

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SP4T-C

100–20000 MHz IC conmutador RF — SP4T; TTL

100–20000 MHz; SP4T; Pérdida de inserción -2.6 dB (típico); Aislamiento -50 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

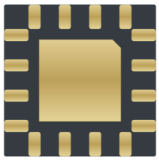
Pérdida de inserción: Símbolo: IL; Típico: -2.6; Unidad: dB

Aislamiento: Símbolo: ISO; Típico: -50; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-SW-100-20000-SPDT-C

100–20000 MHz IC conmutador RF — SPDT; TTL

100–20000 MHz; SPDT; Pérdida de inserción -2.2 dB (típico); Aislamiento -45 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Símbolo: IL; Típico: -2.2; Unidad: dB

Aislamiento: Símbolo: ISO; Típico: -45; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.22

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Circuitos integrados beamformer RF



LCI-BF-14000-18000-4CH

14000–18000 MHz Die formador de haces SiGe T/R de cuatro canales

Paso de fase: 5.625 °; Rango de atenuación: 0–31.5 dB; Tiempo de conmutación: 100 ns (máximo). Dimensiones del die en planta: 5 × 6.2 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

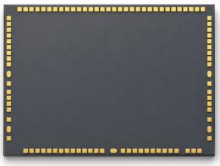
VSWR de entrada/salida: Típico: 1.8

Error RMS de fase: Máximo: 3; Unidad: °

Error RMS de atenuación: Máximo: 0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-BF-8000-12000-2CH

8000–12000 MHz Die formador de haces Si T/R de dos canales

Paso de fase: 5.625 ° (típico); Paso de atenuación: 0.5 dB (típico). Dimensiones del die: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

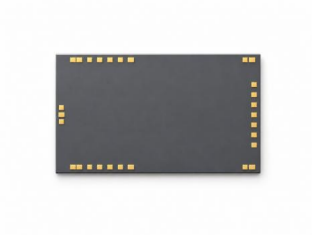
Resolución de control de fase: Valor: 6; Unidad: bit

Resolución de control de atenuación: Valor: 6; Unidad: bit

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 0; Máximo: 360; Unidad: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-BF-3700-5000-2CH

3700–5000 MHz Die GaAs MMIC de control de fase y atenuación de dos canales — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT

3700–5000 MHz; Pérdida de inserción -13 dB (típico); Error RMS de atenuación en 64 estados 0.2 dB (típico); Error RMS de fase en 64 estados 2 ° (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: -13; Unidad: dB

Rango de atenuación: Máximo: 31.5; Unidad: dB

Error RMS de atenuación en 64 estados: Típico: 0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Circuitos integrados desfasadores RF



LCI-PS-1200-1400-6B-D

1200–1400 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 0.5 ° (mínimo) / 0.7 ° (típico) / 1 ° (máximo); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo); Pérdida de inserción: ≈5 dB. Dimensiones del die: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 1200; Máximo: 1400; Valor: 1200–1400; Unidad: MHz

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Mínimo: 0.5; Típico: 0.7; Máximo: 1; Unidad: °

Variación de amplitud inducida por el desplazamiento de fase: Típico: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-5000-6000-6B

5000–6000 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 1 ° (típico); Pérdida de inserción: 7 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

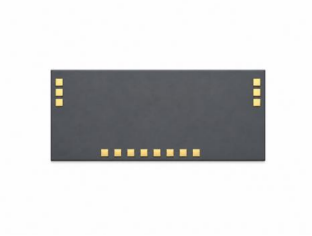
Pérdida de inserción: Típico: 7; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 1; Unidad: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-2700-3500-6B

2700–3500 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 1 ° (típico); Pérdida de inserción: 5.5 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 5.5; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 1; Unidad: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-15000-23000-6B

15000–23000 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 1.4 ° (típico); Pérdida de inserción: 9.5 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 15000; Máximo: 23000; Valor: 15000–23000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 9.5; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 1.4; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-25000-33000-6B

25000–33000 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 1.6 ° (típico); Pérdida de inserción: 9.5 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 25000; Máximo: 33000; Valor: 25000–33000; Unidad: MHz

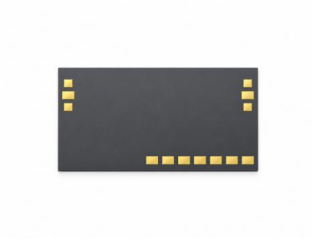
Pérdida de inserción: Típico: 9.5; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 1.6; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 1.2 ° (típico); Pérdida de inserción: 7 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 7; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 1.2; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-900-1400-6B-D

900–1400 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 1.5 ° (típico); Pérdida de inserción: 5 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 900; Máximo: 1400; Valor: 900–1400; Unidad: MHz

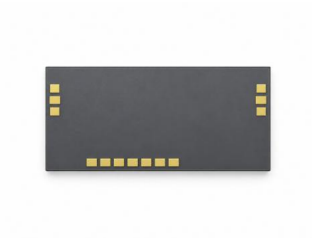
Pérdida de inserción: Típico: 5; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 1.5; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-1200-1600-6B-D

1200–1600 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 0.8 ° (típico); Pérdida de inserción: 4.3 dB (típico); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 4.3; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 0.8; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-2000-8000-6B

2000–8000 MHz Die desfasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de fase: 2.2 ° (típico) / 3 ° (máximo); Pérdida de inserción: 10 dB (típico) / 11.5 dB (máximo); Rango de desplazamiento de fase: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensiones del die: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Valor: 2000–8000; Unidad: MHz

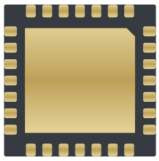
Pérdida de inserción: Típico: 10; Máximo: 11.5; Unidad: dB

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Error RMS de fase: Típico: 2.2; Máximo: 3; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-900-1400-6B-C

900–1400 MHz IC desfasador digital — 6-bit; RMS 1.5° (típico)

900–1400 MHz; Error RMS de fase en 64 estados 1.5 ° (típico); Variación de amplitud inducida por el desplazamiento de fase ±0.4 dB (típico); VSWR de entrada 1.5 (típico); VSWR de salida 1.4 (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 900; Máximo: 1400; Valor: 900–1400; Unidad: MHz

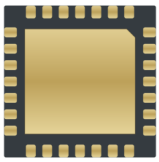
Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Pérdida de inserción: Típico: -5.4; Unidad: dB

Error RMS de fase en 64 estados: Típico: 1.5; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-1200-1400-6B-C

1200–1400 MHz IC desfasador digital — 6-bit; RMS 0.7° (típico)

1200–1400 MHz; Error RMS de fase en 64 estados 0.7 ° (típico); Variación de amplitud inducida por el desplazamiento de fase ±0.5 dB (típico); VSWR de entrada 1.4 (típico); VSWR de salida 1.4 (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1400; Valor: 1200–1400; Unidad: MHz

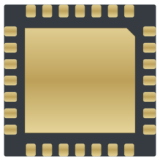
Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Pérdida de inserción: Típico: -5.4; Unidad: dB

Error RMS de fase en 64 estados: Típico: 0.7; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-1200-1600-6B-C

1200–1600 MHz IC desfasador digital — 6-bit; RMS 0.8° (típico)

1200–1600 MHz; Error RMS de fase en 64 estados 0.8 ° (típico); Variación de amplitud inducida por el desplazamiento de fase ±0.4 dB (típico); VSWR de entrada 1.4 (típico); VSWR de salida 1.4 (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidad: MHz

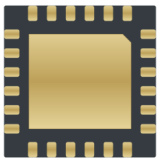
Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidad: °

Pérdida de inserción: Típico: -4.7; Unidad: dB

Error RMS de fase en 64 estados: Típico: 0.8; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-PS-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz IC desfasador digital — 6-bit; RMS 1.2° (típico)

14000–18000 MHz; Error RMS de fase en 64 estados 1.2 ° (típico); Variación de amplitud inducida por el desplazamiento de fase ±0.3 dB (típico); VSWR de entrada 1.5 (típico); VSWR de salida 1.3 (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Rango de desplazamiento de fase: Mínimo: 5.625; Unidad: °

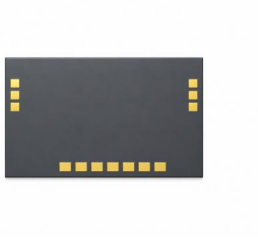
Pérdida de inserción: Típico: -7.4; Unidad: dB

Error RMS de fase en 64 estados: Típico: 1.2; Unidad: °

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Circuitos integrados atenuadores digitales RF



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Die atenuador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de atenuación: 0.3 dB (típico); Pérdida de inserción: 4 dB (máximo); Rango de atenuación: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo). Dimensiones del die: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

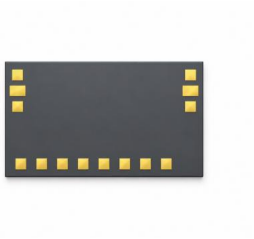
Pérdida de inserción: Máximo: 4; Unidad: dB

Rango de atenuación: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidad: dB

Error RMS de atenuación: Típico: 0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz Die atenuador digital GaAs MMIC de 6 bits

Error RMS de atenuación: 0.2 dB (típico); Pérdida de inserción: 1.6 dB (típico); Rango de atenuación: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo). Dimensiones del die: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 8000; Valor: DC–8000; Unidad: MHz

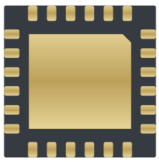
Pérdida de inserción: Típico: 1.6; Unidad: dB

Rango de atenuación: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidad: dB

Error RMS de atenuación: Típico: 0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-ATT-100-8000-6B

100–8000 MHz IC atenuador digital por pasos — 6-bit; 0.5 dB

100–8000 MHz; Rango de atenuación 0.5–31.5 dB; Precisión de atenuación 0.2 dB (típico); Pérdida de inserción 2 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 8000; Valor: 100–8000; Unidad: MHz

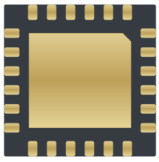
Pérdida de inserción: Típico: 2; Unidad: dB

Rango de atenuación: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidad: dB

Precisión de atenuación: Típico: 0.2; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-ATT-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz IC atenuador digital por pasos — 6-bit; 0.5 dB

14000–18000 MHz; Rango de atenuación 0.5–31.5 dB; Precisión de atenuación 0.3 dB (típico); Pérdida de inserción 2 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 2; Unidad: dB

Rango de atenuación: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidad: dB

Precisión de atenuación: Típico: 0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TTD-5000-6000-4B

5000–6000 MHz Die de retardo temporal digital GaAs MMIC de 4 bits

Retardo temporal: 92.5 ps (típico) (T1; t_nom = 92.59 ps); Retardo temporal: 737 ps (típico) (T4; t_nom = 740.74 ps); Pérdida de inserción: 12 dB (típico) / 13 dB (máximo). Dimensiones del die: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidad: MHz

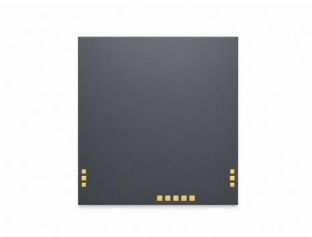
Pérdida de inserción: Típico: 12; Máximo: 13; Unidad: dB

Retardo temporal (T1): Típico: 92.5; Valor: T1; t_nom = 92.59 ps; Unidad: ps

Retardo temporal (T2): Típico: 184; Valor: T2; t_nom = 185.185 ps; Unidad: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TTD-8500-10500-4B

8500–10500 MHz Die de retardo temporal digital GaAs MMIC de 4 bits

Retardo temporal: 52.7 ps (típico) (T1; t_nom = 52 ps); Retardo temporal: 416 ps (típico) (T4; t_nom = 416 ps); Pérdida de inserción: 12 dB (típico) / 13 dB (máximo). Dimensiones del die: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Valor: 8500–10500; Unidad: MHz

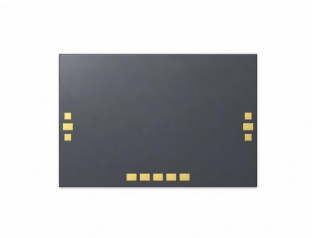
Pérdida de inserción: Típico: 12; Máximo: 13; Unidad: dB

Retardo temporal (T1): Típico: 52.7; Valor: T1; t_nom = 52 ps; Unidad: ps

Retardo temporal (T2): Típico: 102; Valor: T2; t_nom = 104 ps; Unidad: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TTD-8000-12000-3B

8000–12000 MHz Die de retardo temporal digital GaAs MMIC de 3 bits

Retardo temporal: 25 ps (típico) (T1; t_nom = 25 ps); Retardo temporal: 102 ps (típico) (T3; t_nom = 100 ps); Pérdida de inserción: 6 dB (típico) / 7 dB (máximo). Dimensiones del die: 3 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

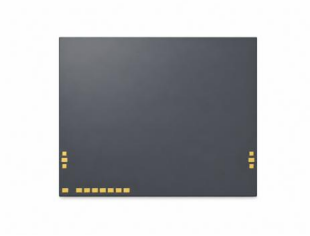
Pérdida de inserción: Típico: 6; Máximo: 7; Unidad: dB

Retardo temporal (T1): Típico: 25; Valor: T1; t_nom = 25 ps; Unidad: ps

Retardo temporal (T2): Típico: 49.5; Valor: T2; t_nom = 50 ps; Unidad: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TTD-200-2000-6B

200–2000 MHz Die de retardo temporal digital GaAs MMIC de 6 bits

Retardo temporal: 25 ps (típico) (T1; t_nom = 25 ps); Retardo temporal: 800 ps (típico) (T6; t_nom = 800 ps); Pérdida de inserción: 11 dB (máximo). Dimensiones del die: 5 × 4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 200; Máximo: 2000; Valor: 200–2000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Máximo: 11; Unidad: dB

Retardo temporal (T1): Típico: 25; Unidad: ps; Notas: T1; t_nom = 25 ps

Retardo temporal (T2): Típico: 50; Unidad: ps; Notas: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-TTD-7000-13000-3B

7000–13000 MHz Die de retardo temporal digital GaAs MMIC de 3 bits

Retardo temporal: 52 ps (típico) (T1; t_nom = 52 ps); Retardo temporal: 208 ps (típico) (T3; t_nom = 208 ps); Pérdida de inserción: 9 dB (típico). Dimensiones del die: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: 9; Unidad: dB

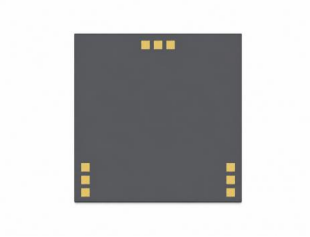
Retardo temporal (T1): Típico: 52; Valor: T1; t_nom = 52 ps; Unidad: ps

Retardo temporal (T2): Típico: 104; Valor: T2; t_nom = 104 ps; Unidad: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Dispositivos pasivos RF integrados



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 2 × 2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidad: MHz

Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidad: MHz

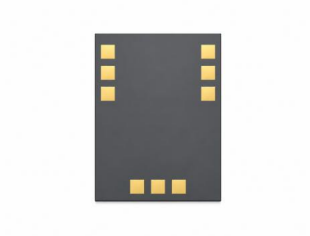
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 14 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 500; Máximo: 2700; Valor: 500–2700; Unidad: MHz

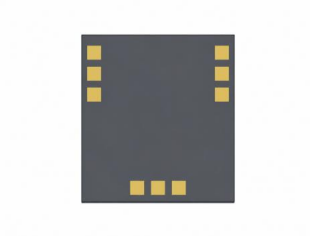
Aislamiento: Típico: 14; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidad: MHz

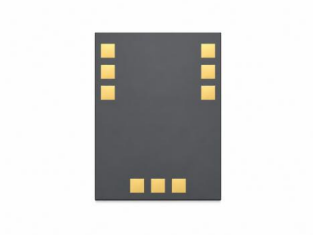
Aislamiento: Típico: 18; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.4 (típico); VSWR de salida: 1.4 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 1000; Máximo: 4000; Valor: 1000–4000; Unidad: MHz

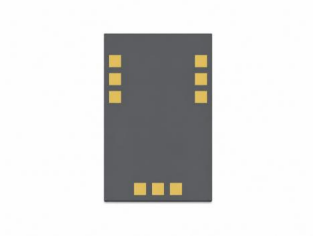
Aislamiento: Típico: 18; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de salida: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

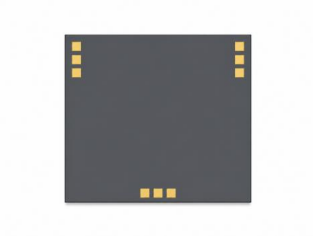
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidad: MHz

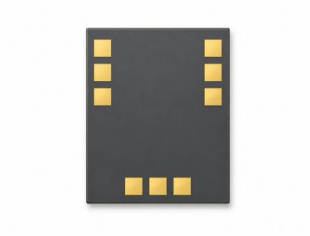
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

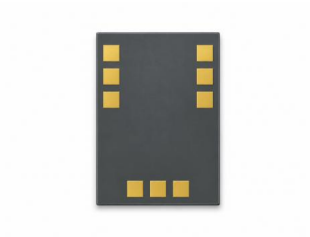
Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 7000; Valor: 5000–7000; Unidad: MHz

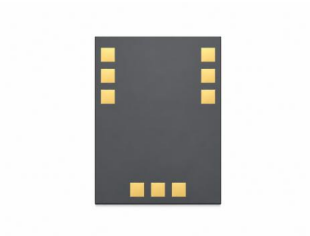
Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidad: MHz

Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidad: MHz

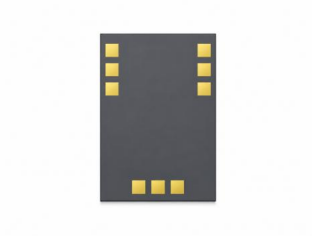
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidad: MHz

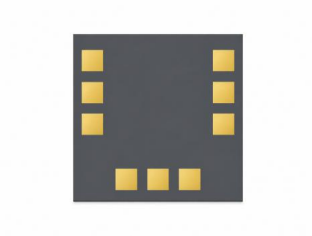
Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidad: MHz

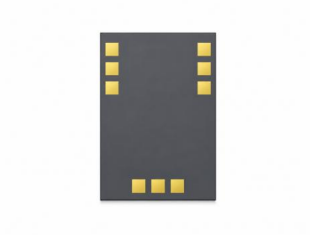
Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.2 (típico). Dimensiones del die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 10000; Máximo: 20000; Valor: 10000–20000; Unidad: MHz

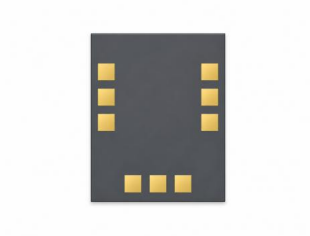
Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidad: MHz

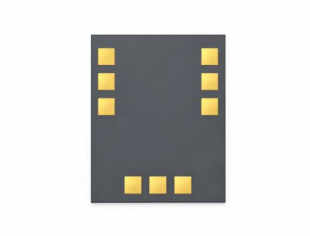
Aislamiento: Típico: 25; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de salida: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

Aislamiento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de salida: 1.3 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 30000; Máximo: 40000; Valor: 30000–40000; Unidad: MHz

Aislamiento: Típico: 20; Unidad: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de salida: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 0 dB

Atenuación: 0 dB; VSWR de entrada/salida: 1.2 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 0; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.2

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 1 dB

Atenuación: 1 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 1; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 2 dB

Atenuación: 2 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 2; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 3 dB

Atenuación: 3 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 3; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 4 dB

Atenuación: 4 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 4; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 8 dB

Atenuación: 8 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 8; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 16 dB

Atenuación: 16 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 16; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 0 dB

Atenuación: 0 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.6 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 0; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.6; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 1 dB

Atenuación: 1 dB; VSWR de entrada/salida: 1.4 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 1; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.4

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 2 dB

Atenuación: 2 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 2; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 3 dB

Atenuación: 3 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 3; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 5 dB

Atenuación: 5 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 5; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 6 dB

Atenuación: 6 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 6; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 8 dB

Atenuación: 8 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 8; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 10 dB

Atenuación: 10 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

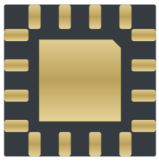
Atenuación: Valor: 10; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz Cruce RF encapsulado — ISO 30 dB (típico)

DC–40000 MHz; Pérdida de inserción -1.4 dB (típico); Aislamiento 30 dB (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 40000; Valor: DC–40000; Unidad: MHz

Pérdida de inserción: Típico: -1.4; Unidad: dB

Aislamiento: Típico: 30; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Circuitos integrados mezcladores y convertidores



LCI-MIX-500-2000-D

500–2000 MHz Die mezclador pasivo doblemente balanceado GaAs MMIC

Pérdida de conversión: 9 dB (típico); Potencia de LO: 15 dBm; Frecuencia de funcionamiento (IF): 0 MHz (mínimo) / 900 MHz (máximo) / DC–900 MHz. Dimensiones del die: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 500; Máximo: 2000; Valor: 500–2000 (RF / LO); Unidad: MHz

Frecuencia de funcionamiento (IF): Mínimo: 0; Máximo: 900; Valor: DC–900; Unidad: MHz

Pérdida de conversión: Típico: 9; Unidad: dB

Aislamiento (LO / RF): Típico: 45; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-MIX-7000-10000-D

7000–10000 MHz Die mezclador pasivo doblemente balanceado GaAs MMIC

Pérdida de conversión: 8.5 dB (típico); Potencia de LO: 14 dBm; Frecuencia de funcionamiento (IF): 1400 MHz (mínimo) / 3000 MHz (máximo) / 1400–3000 MHz. Dimensiones del die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 7000; Máximo: 10000; Valor: 7000–10000 (RF); Unidad: MHz

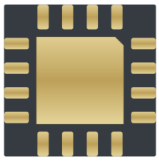
Frecuencia de funcionamiento (LO): Mínimo: 5000; Máximo: 9000; Valor: 5000–9000; Unidad: MHz

Frecuencia de funcionamiento (IF): Mínimo: 1400; Máximo: 3000; Valor: 1400–3000; Unidad: MHz

Pérdida de conversión: Típico: 8.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-MIX-500-2000-C

500–2000 MHz Mezclador pasivo doblemente equilibrado encapsulado — LO +14 dBm; IL -9 dB (típico)

500–2000 MHz; IF DC–900 MHz; Pérdida de conversión -9 dB (típico); LOin = 14 dBm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 500; Máximo: 2000; Valor: 500–2000; Unidad: MHz

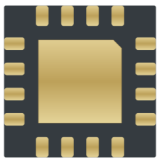
Rango de frecuencia IF: Mínimo: DC; Máximo: 900; Unidad: MHz

Pérdida de conversión: Símbolo: IL; Típico: -9; Unidad: dB

Aislamiento LO–RF: Símbolo: ISOL-R; Típico: -40; Unidad: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCI-MIX-7000-10000-C

7000–10000 MHz Mezclador pasivo doblemente equilibrado encapsulado — LO +14 dBm; IL -9 dB (típico)

7000–10000 MHz; IF 1400–3400 MHz; Pérdida de conversión -9 dB (típico); LOin = 14 dBm.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 10000; Valor: 7000–10000; Unidad: MHz

Rango de frecuencia IF: Mínimo: 1400; Máximo: 3400; Unidad: MHz

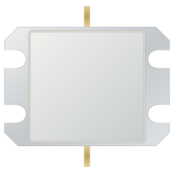
Pérdida de conversión: Símbolo: IL; Típico: -9; Unidad: dB

Aislamiento LO–RF: Símbolo: ISOL-R; Típico: -40; Unidad: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Transistores de potencia RF



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 51 dBm (típico)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganancia de potencia 11 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5700; Máximo: 7100; Valor: 5700–7100; Unidad: MHz

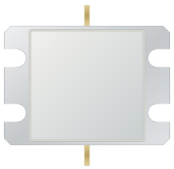
Potencia de salida saturada: Mínimo: 50.5; Típico: 51; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 10.5; Típico: 11; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 40; Típico: 45; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 56.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 13.5 dB (típico); PAE 55 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

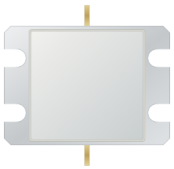
Potencia de salida saturada: Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 50; Típico: 55; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 56.5 dBm (típico)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 12.5 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 5300; Máximo: 5900; Valor: 5300–5900; Unidad: MHz

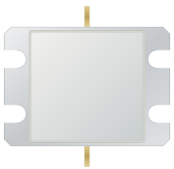
Potencia de salida saturada: Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 40; Típico: 45; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 48.5 dBm (típico)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 12.5 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidad: MHz

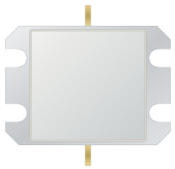
Potencia de salida saturada: Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 53.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (típico); Ganancia de potencia 13.5 dB (típico); PAE 65 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidad: MHz

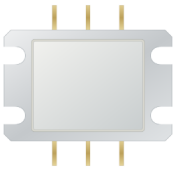
Potencia de salida saturada: Mínimo: 53; Típico: 53.5; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 60; Típico: 65; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 50 dBm (típico)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (típico); Ganancia de potencia 12 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2300; Máximo: 3900; Valor: 2300–3900; Unidad: MHz

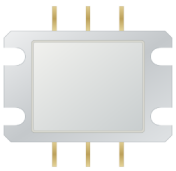
Potencia de salida saturada: Mínimo: 49; Típico: 50; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 11; Típico: 12; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 49 dBm (típico)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (típico); Ganancia de potencia 13 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3700; Valor: 2600–3700; Unidad: MHz

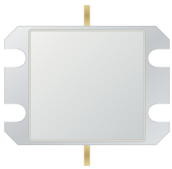
Potencia de salida saturada: Mínimo: 48; Típico: 49; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 12; Típico: 13; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidad: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 51 dBm (típico)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganancia de potencia 9 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 9600; Valor: 8500–9600; Unidad: MHz

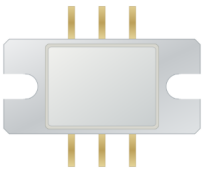
Potencia de salida saturada: Mínimo: 50; Típico: 51; Unidad: dBm

Ganancia de potencia: Mínimo: 8; Típico: 9; Unidad: dB

Eficiencia de potencia añadida: Típico: 38; Unidad: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6000 MHz; Potencia de salida de referencia 45.51 dBm (típico); Ganancia de potencia 19.51 dB (típico); Eficiencia de drenador 39.82 % (típico) @ 6000 MHz.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidad: MHz

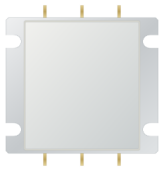
Potencia de salida de referencia: Típico: 45.51; Unidad: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganancia de potencia: Típico: 19.51; Unidad: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiencia de drenador: Símbolo: ηD; Típico: 39.82; Unidad: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (típico)

700–6200 MHz; Potencia de salida saturada 49 dBm (típico); Ganancia de potencia 7 dB (típico); Eficiencia de drenador 35 % (típico) @ 6000 MHz.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 6200; Valor: 700–6200; Unidad: MHz

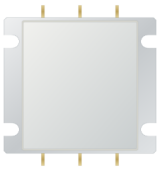
Potencia de salida saturada: Símbolo: Psat; Típico: 49; Unidad: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganancia de potencia: Típico: 7; Unidad: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiencia de drenador: Símbolo: ηD; Típico: 35; Unidad: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN Transistor de potencia con adaptación interna — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6200 MHz; Potencia de salida de referencia 50.1 dBm (típico); Ganancia de potencia 8.6 dB (típico); Eficiencia de drenador 52.4 % (típico) @ 6000 MHz.

Frecuencia de funcionamiento: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6200; Valor: 2000–6200; Unidad: MHz

Potencia de salida de referencia: Típico: 50.1; Unidad: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganancia de potencia: Típico: 8.6; Unidad: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiencia de drenador: Símbolo: ηD; Típico: 52.4; Unidad: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.